

Предметный указатель

Содержание

1.	Персоналии	1515
2.	Обзоры	1515
3.	Электромагнетизм, оптика, акустика (PACS 40)	1515
3.1.	Полупроводниковые лазеры (PACS 42.55.Px)	1516
4.	Структура, механические и термические свойства (PACS 60)	1516
4.1.	Структура, кристаллография (PACS 61)	1516
4.1.1.	Исследование структуры полупроводников (PACS 61.10-61.16)	1517
4.1.2.	Аморфные, стеклообразные полупроводники (PACS 61.43)	1517
4.1.3.	Кластеры и наночастицы (PACS 61.46)	1517
4.1.4.	Дефекты в кристаллах (PACS 61.72)	1518
4.1.5.	Физические эффекты, связанные с облучением. Радиационные дефекты (PACS 61.80)	1518
4.2.	Механические и акустические свойства (PACS 62). Динамика решетки (PACS 63)	1518
4.3.	Фазовые равновесия и фазовые переходы (PACS 64)	1519
4.4.	Термические свойства (PACS 65). Диффузия и теплопроводность (PACS 66)	1519
4.5.	Структура поверхностей, границ раздела и тонких пленок (PACS 68)	1519
5.	Электронная структура, электрические, магнитные и оптические свойства (PACS 70)	1520
5.1.	Электронные состояния (PACS 71)	1520
5.1.1.	Уровни дефектов и примесей (PACS 71.55)	1521
5.2.	Транспортные явления (PACS 72)	1521
5.2.1.	Явления электронной проводимости в полупроводниках (PACS 72.20)	1522
5.2.2.	Высокочастотные эффекты и эффекты обусловленные плазмой (PACS 72.30)	1523
5.2.3.	Фотопроводимость и фотовольтаический эффект (PACS 72.40)	1523
5.3.	Электронная структура и электрические свойства поверхностей, границ раздела и тонких пленок (PACS 73)	1523
5.3.1.	Электронные состояния на поверхностях и границах раздела (PACS 73.20)	1525
5.3.2.	Барьеры Шоттки (PACS 73.30)	1526
5.3.3.	Транспортные явления в структурах, содержащих границы раздела (PACS 73.40)	1526
5.3.4.	Транспортные явления в тонких пленках (PACS 73.50)	1527
5.4.	Сверхпроводимость (PACS 74). Магнитные свойства (PACS 75), магнитные резонансы (PACS 76)	1528
5.5.	Диэлектрические и пьезоэлектрические свойства (PACS 77)	1528
5.6.	Оптические свойства полупроводников, спектроскопия, взаимодействие с различными видами излучений (PACS 78)	1529
5.6.1.	Оптические свойства объемных материалов (PACS 78.20)	1530

5.6.2.	Инфракрасная спектроскопия, комбинационное рассеяние (PACS 78.30)	1530
5.6.3.	Люминесценция, излучательная рекомбинация (PACS 78.55; 78.60)	1531
5.6.4.	Оптические свойства тонких пленок, поверхностей и структур, содержащих границы раздела (сверхрешетки, гетеропереходы и т. п.) (PACS 78.66)	1532
5.7.	Эмиссия электронов и ионов. Ударная ионизация (PACS 79)	1533
6.	Технология, материаловедение, применение полупроводников (PACS 80)	1533
6.1.	Методы получения и обработки полупроводниковых материалов (PACS 81; 82)	1533
6.2.	Полупроводниковые приборы (PACS 84; 85)	1535

1. Персоналии

Борис Петрович Захарченя	5	641
Памяти Анатолия Робертовича Регеля (к 90-летию со дня рождения)	8	1021
Юрий Васильевич Гуляев (к 70-летию со дня рождения)	11	1408
Борис Васильевич Царенков (к 75-летию со дня рождения)	12	1478
Юрий Васильевич Шмарцев (к 75-летию со дня рождения)	12	1478
Юрас Пожела (к 80-летию со дня рождения)	12	1478

2. Обзоры

Мощные биполярные приборы на основе карбида кремния . П.А. Иванов, М.Е. Левинштейн, Т.Т. Мнацаканов, J.W. Palmour, А.К. Agarwal	8	897
Светодиоды на основе твердых растворов GaSb для средней инфракрасной области спектра 1.6–4.4 мкм . Т.Н. Данилова, Б.Е. Журтанов, А.Н. Именков, Ю.П. Яковлев	11	1281

3. Электромагнетизм, оптика, акустика (PACS 40)

Исследование ориентации молекул жидкого кристалла E7 в композитах на основе щелевого кремния поляризационными методами инфракрасной спектроскопии и комбинационного рассеяния света . Е.В. Астрова, Т.С. Перова, С.А. Грудинкин, В.А. Толмачев, Ю.А. Пилюгина, В.Б. Воронков, J.K. Vij	7	793
Оптические переходы в квантованном цилиндрическом слое при наличии однородного электрического поля . В.А. Арутюнян, С.Л. Арутюнян, Г.О. Демирчян, Г.Ш. Петросян	7	839

- Светочувствительные свойства и механизм фотогенерации носителей заряда в полимерных слоях, содержащих металлоорганические комплексы. Е.Л. Александрова, М.Я. Гойхман, И.В. Подешво, В.В. Кудрявцев 7 880
- Структуры полупроводник—диэлектрик в фотомешениях видиконов, чувствительных в средней инфракрасной области спектра. Н.Ф. Ковтонюк, В.П. Мисник, А.В. Соколов 9 1129
- Характеризация фотонных кристаллов на основе композитов опал—полупроводник по спектрам брэгговского отражения света. Г.М. Гаджиев, В.Г. Голубев, Д.А. Курдюков, А.Б. Певцов, А.В. Селькин, В.В. Травников 12 1423
- 3.1. Полупроводниковые лазеры (PACS 42.55.Px)**
- Генератор терагерцевого излучения, основанный на нелинейном преобразовании частоты в двойном вертикальном резонаторе. Ю.А. Морозов, И.С. Нефедов, В.Я. Алешкин, И.В. Красникова . . . 1 124
- Наблюдение излучения среднего инфракрасного диапазона в полупроводниковых лазерах, генерирующих две частотные полосы в ближнем инфракрасном диапазоне. В.Я. Алешкин, В.И. Гавриленко, С.В. Морозов, К.В. Маремьянин, Б.Н. Звонков, С.М. Некоркин 1 153
- Конкуренция мод, неустойчивость и генерация вторых гармоник в двухчастотных лазерах InGaAs/GaAs/InGaP. В.Я. Алешкин, Б.Н. Звонков, С.М. Некоркин, Вл.В. Кочаровский 1 171
- Мощные полупроводниковые лазеры на основе асимметричных гетероструктур раздельного ограничения. Д.А. Винокуров, С.А. Зорина, В.А. Капитонов, А.В. Мурашова, Д.Н. Николаев, А.Л. Станкевич, М.А. Хомылев, В.В. Шамахов, А.Ю. Лешко, А.В. Лютецкий, Т.А. Налет, Н.А. Пихтин, С.О. Слипченко, З.Н. Соколова, Н.В. Фетисова, И.С. Тарасов 3 388
- Конструкция и технология изготовления матриц вертикально-излучающих лазеров. Н.А. Малеев, А.Г. Кузьменков, А.Е. Жуков, А.П. Васильев, А.С. Шуленков, С.В. Чумаков, Е.В. Никитина, С.А. Блохин, М.М. Кулагина, Е.С. Семенова, Д.А. Лившиц, М.В. Максимов, В.М. Устинов 4 487
- Интерфейсная и межзонная лазерная генерация в гетероструктуре InAs/InAsSbP, выращенной методом газовой эпитаксии из металлоорганических соединений. А.П. Астахова, Н.Д. Ильинская, А.Н. Именков, С.С. Кижасев, С.С. Молчанов, Ю.П. Яковлев 4 497
- Влияние *p*-легирования активной области на температурную стабильность характеристик лазеров на InAs/GaAs-квантовых точках. И.И. Новиков, Н.Ю. Гордеев, Л.Я. Карачинский, М.В. Максимов, Ю.М. Шерняков, А.Р. Ковш, И.Л. Крестников, А.В. Кожухов, С.С. Михрин, Н.Н. Леденцов 4 502
- Температурная зависимость эффективного коэффициента оже-рекомбинации в лазерах InAs/GaAs на квантовых точках с длиной волны излучения 1.3 мкм. И.И. Новиков, Н.Ю. Гордеев, М.В. Максимов, Ю.М. Шерняков, Е.С. Семенова, А.П. Васильев, А.Е. Жуков, В.М. Устинов, Г.Г. Зегря 4 507
- Влияние эффекта насыщения усиления на мощность излучения полупроводниковых лазеров на квантовых ямах. Г.Г. Зегря, И.Ю. Соловьев 5 636
- Оптические свойства гетероструктур с квантово-размерными слоями InGaAsN на подложках GaAs, излучающих в области 1.3—1.55 мкм. Н.В. Крыжановская, А.Ю. Егоров, В.В. Мамутин, Н.К. Поляков, А.Ф. Цацуньников, А.Р. Ковш, Н.Н. Леденцов, В.М. Устинов, Д. Бимберг 6 735
- Полупроводниковые WGM-лазеры среднего инфракрасного диапазона. В.В. Шерстнев, А.М. Монахов, А.П. Астахова, А.Ю. Кислякова, Ю.П. Яковлев, Н.С. Аверкиев, А. Klier, G. Hill 9 1122
- Температурная зависимость порогового тока лазеров на квантовых ямах. Н.Л. Баженов, К.Д. Мынбаев, В.И. Иванов-Омский, В.А. Смирнов, В.П. Евтихийев, Н.А. Пихтин, М.Г. Растегаева, А.Л. Станкевич, И.С. Тарасов, А.С. Школьник, Г.Г. Зегря 10 1252
- Непрерывный режим генерации одномодовых метаморфных лазеров на квантовых точках спектрального диапазона 1.5 мкм. Л.Я. Карачинский, Т. Kettler, Н.Ю. Гордеев, И.И. Новиков, М.В. Максимов, Ю.М. Шерняков, Н.В. Крыжановская, А.Е. Жуков, Е.С. Семенова, А.П. Васильев, В.М. Устинов, Н.Н. Леденцов, А.Р. Ковш, В.А. Щукин, С.С. Михрин, A. Lochmann, O. Schulz, L. Reissmann, D. Bimberg 12 1464
- 4. Структура, механические и термические свойства (PACS 60)**
- 4.1. Структура, кристаллография (PACS 61)**
- Atmospheric adsorption effects in hot wire chemical vapour deposition microcrystalline silicon films with different electrode configurations. S.K. Persheyev, V. Smirnov, K.A. O'Neill, S. Reynolds, M.J. Rose . . . 3 361
- Спектры комбинационного рассеяния света монокристаллов GaSe, подвергнутых воздействию лазерного облучения. А. Байдуллаева, З.К. Власенко, Б.К. Даулетмуратов, Л.Ф. Кузан, П.Е. Мозоль 4 405
- Исследование ориентации молекул жидкого кристалла E7 в композитах на основе щелевого кремния поляризационными методами инфракрасной спектроскопии и комбинационного рассеяния света. Е.В. Астрова, Т.С. Перова, С.А. Грудинкин, В.А. Толмачев, Ю.А. Пилгогина, В.Б. Воронков, J.K. Vij 7 793
- Процессы роста неупорядоченных полупроводников с позиций теории самоорганизации. С.П. Вихров, Н.В. Бодягин, Т.Г. Ларина, С.М. Мурсалов 8 953
- Электронно-микроскопические исследования микроструктуры поликристаллических конденсатов на основе халькогенидов: влияние состава и толщины на внутреннее искривление кристаллической решетки. В.Ю. Колосов, Л.М. Веретенников, Ю.Б. Старцева, К.Л. Швамм 8 990
- Образование наноразмерных структур на поверхности кристаллов *p*-CdTe при однократном воздействии импульсом излучения рубинового лазера. А. Байдуллаева, А.И. Власенко, Л.Ф. Кузан, О.С. Литвин, П.Е. Мозоль 9 1064

Динамика лазерно-индуцированных фазовых переходов в теллуриде кадмия. А.А. Ковалев, С.П. Жвабый, Г.Л. Зыков	11	1345
Нанокompозиты опал-ZnO: структура и эмиссионные свойства. Г.А. Емельченко, А.Н. Грузинцев, М.Н. Ковальчук, В.М. Маслов, Э.Н. Самаров, Е.Е. Якимов, С. Varthou, И.И. Зверькова	11	1374
Электролюминесценция варизонных структур с антизапорным и омическим контактами. Б.С. Соколовский, В.И. Иванов-Омский, Г.А. Ильчук	12	1409

4.1.1. Исследование структуры полупроводников (PACS 61.10-61.16)

Исследование локальной электронной и атомной структуры в аморфных сплавах $a\text{-Si}_x\text{C}_{1-x}$ методом ультрамягкой рентгеновской спектроскопии. В.А. Терехов, Е.И. Торуков, И.Н. Трапезникова, В.М. Кашкаров, О.В. Курило, С.Ю. Турищев, А.Б. Голоденко, Э.П. Домашевская	7	863
Причины устойчивости трехбислойных островков и ступеней на поверхности Si(111). А.В. Зверев, И.Г. Неизвестный, И.А. Рейзвих, К.Н. Романюк, С.А. Тийс, Н.Л. Шварц, З.Ш. Яновицкая	8	1002
Some Aspects to the RHEED Behaviour of LT-GaAs Growth. Ákos Nemcsics	11	1398

4.1.2. Аморфные, стеклообразные полупроводники (PACS 61.43)

О механизме инжекционных токов в светонизлучающих $p-i-n$ -структурах на основе гидрогенизированных аморфных сплавов $a\text{-Si}_{1-x}\text{C}_x$: Н. А.А. Андреев	2	276
Atmospheric adsorption effects in hot wire chemical vapour deposition microcrystalline silicon films with different electrode configurations. S.K. Persheyev, V. Smirnov, K.A. O'Neill, S. Reynolds, M.J. Rose	3	361
Особенности электропроводности легированных пленок $a\text{-Si}:H$ с нанокристаллами кремния. С.А. Аржанникова, М.Д. Ефремов, Г.Н. Камаев, А.В. Вишняков, В.А. Володин	4	472
Влияние температуры вакуумного отжига на край фундаментального поглощения и структурную релаксацию пленок $a\text{-SiC}:H$. А.В. Васин, А.В. Русавский, В.С. Лысенко, А.Н. Назаров, В.И. Кушниренко, С.П. Старик, В.Г. Степанов	5	602
Поведение структурных дефектов и проводимости в легированных бором пленках $nc\text{-SiC}:H$, выращенных методом photo-CVD. О.И. Шевалеский, S.Y. Myong, K.S. Lim, S. Miyajima, M. Konagai	6	741
Оптические и электрические свойства тонких пластин, изготовленных из нанокристаллических порошков кремния. Н.Н. Кононов, Г.П. Кузьмин, А.Н. Орлов, А.А. Сурков, О.В. Тихоневич	7	868
Процессы роста неупорядоченных полупроводников с позиций теории самоорганизации. С.П. Вихров, Н.В. Бодягин, Т.Г. Ларина, С.М. Мурсалов	8	953
Фотоиндуцированная релаксация метастабильных состояний в $a\text{-Si}:H$ (В). Н.Н. Ормонт, И.А. Курова, Г.В. Прокофьев	8	960
Влияние эрбия и кислорода на интенсивность фотолюминесценции эрбия и состав пленок $a\text{-SiO}_x:H(Er,O)$, полученных магнетронным распылением на постоянном токе. Ю.К. Ундалов, Е.И. Торуков, О.Б. Гусев, В.Х. Кудоярова	8	979

Структурные преобразования и оптические свойства халькогенидных стекол As_2S_3 . И.В. Фекешгази, К.В. Май, Н.И. Мателешко, В.М. Мица, Е.И. Боркач	8	986
Электронно-микроскопические исследования микроструктуры поликристаллических конденсатов на основе халькогенидов: влияние состава и толщины на внутреннее искривление кристаллической решетки. В.Ю. Колосов, Л.М. Веретенников, Ю.Б. Старцева, К.Л. Швамм	8	990

4.1.3. Кластеры и наночастицы (PACS 61.46)

Исследование центров рекомбинации, связанных с наноразмерными кластерами As-Sb в низкотемпературном арсениде галлия. П.Н. Брунков, А.А. Гуткин, Ю.Г. Мусихин, В.В. Чалдышев, Н.Н. Берт, С.Г. Конников, В.В. Преображенский, М.А. Пуято, Б.Р. Семягин	1	41
Эффективная фотолюминесценция ближнего инфракрасного диапазона в слоях нитрида галлия, легированного мышьяком. А.В. Андрианов, С.В. Новиков, И.С. Журавлев, Т. Ли, Р. Чаа, С. Булл, И. Харрисон, Е.К. Ларкинс, К.Т. Фоксон	1	82
Исследование способов получения и свойств квантовых молекул InAs в матрице GaAs. Ю.Б. Самсоненко, Г.Э. Цырлин, А.А. Тонких, Н.К. Поляков, Н.В. Крыжановская, В.М. Устинов, Л.Е. Воробьев, Д.А. Фирсов, В.А. Шалыгин, N.D. Zakharov, P. Werner, A. Andreev	1	136
Кинетика и неоднородная инжекция носителей в нанослоях InGaN. Д.С. Сизов, В.С. Сизов, Е.Е. Заварин, В.В. Лундин, А.В. Фомин, А.Ф. Цацульников, Н.Н. Леденцов	2	264
Формирование кремниевых нанокристаллов в слоях SiO_2 при имплантации ионов Si с промежуточными отжигами. Г.А. Качурин, В.А. Володин, Д.И. Тетельбаум, Д.В. Марин, А.Ф. Лейер, А.К. Гутаковский, А.Г. Черков, А.Н. Михайлов	5	582
Поведение структурных дефектов и проводимости в легированных бором пленках $nc\text{-SiC}:H$, выращенных методом photo-CVD. О.И. Шевалеский, S.Y. Myong, K.S. Lim, S. Miyajima, M. Konagai	6	741
Оптические и электрические свойства тонких пластин, изготовленных из нанокристаллических порошков кремния. Н.Н. Кононов, Г.П. Кузьмин, А.Н. Орлов, А.А. Сурков, О.В. Тихоневич	7	868
Образование наноразмерных структур на поверхности кристаллов $p\text{-CdTe}$ при однократном воздействии импульсом излучения рубинового лазера. А. Байдуллаева, А.И. Власенко, Л.Ф. Кузан, О.С. Литвин, П.Е. Мозоль	9	1064
Влияние квантово-размерного эффекта на оптические свойства нанокристаллов Ge в пленках GeO_2 . Е.Б. Горохов, В.А. Володин, Д.В. Марин, Д.А. Орехов, А.Г. Черков, А.К. Гутаковский, В.А. Швец, А.Г. Борисов, М.Д. Ефремов	10	1210
Кинетика фазово-структурных преобразований в тонких пленках SiO_x в процессе быстрого термического отжига. В.А. Данько, И.З. Индутный, В.С. Лысенко, И.Ю. Майданчук, В.И. Минько, А.Н. Назаров, А.С. Ткаченко, П.Е. Шепелявый	10	1239

4.1.4. Дефекты в кристаллах (PACS 61.72)

Исследование активации примеси в InP, имплантированном ионами бериллия, методом фотоотражения. Л.П. Авакянц, П.Ю. Боков, А.В. Червяков	2	189
Исследования медь-углеродных систем методом ЭПР. Б.П. Попов	4	479
Примесная фотопроводимость халькогенов в твердых растворах $Ge_{1-x}Si_x$. Н.Б. Радчук, А.Ю. Ушаков	5	550
Моделирование электрических свойств поликристаллических керамических полупроводников с субмикрометровыми размерами зерен. И.В. Рожанский, Д.А. Зактейм	5	608
Кинетика дефектообразования в ZnO в потоке радикалов кислорода. М.Б. Котляревский, И.В. Рогозин, А.В. Мараховский	6	641
Особенности сегрегационного перераспределения фосфора при термическом окислении сильно легированных слоев кремния. О.В. Александров, Н.Н. Афонин	6	647
О природе температурного гистерезиса эффективного модуля сдвига в монокристаллическом кремнии. А.В. Олейнич-Лысюк, Б.И. Гуцуляк, И.М. Фодчук	7	769
Влияние кислорода на образование донорных центров в слоях кремния, имплантированных ионами эрбия и кислорода. О.В. Александров, А.О. Захарьин, Н.А. Соболев	7	776
Исследование механических напряжений в селективно-окисленных структурах $GaAs/(AlGa)_xO_y$. С.А. Блохин, А.Н. Смирнов, А.В. Сахаров, А.Г. Гладышев, Н.В. Крыжановская, Н.А. Малеев, А.Е. Жуков, Е.С. Семенова, Д.А. Бедарев, Е.В. Никитина, М.М. Кулагина, М.В. Максимов, Н.Н. Леденцов, В.М. Устинов	7	782
Низкотемпературные нестабильности электрических свойств полупроводников кристаллов $Cd_{0.96}Zn_{0.04}Te:Cl$. А.В. Савицкий, О.А. Парфенюк, М.И. Илашук, К.С. Уляницкий, С.Н. Чупыра, Н.Д. Вахняк	7	788
Фотоиндуцированная релаксация метастабильных состояний в $\alpha-Si:H(V)$. Н.Н. Ормонт, И.А. Курова, Г.В. Прокофьев	8	960
Точная самокомпенсация проводимости в кристалле $Cd_{0.95}Zn_{0.05}Te:Cl$ в широком интервале давлений пара Cd. О.А. Матвеев, А.И. Терентьев, Н.К. Зеленина, В.Н. Гуськов, В.Е. Седов, А.А. Томасов, В.П. Карпенко	9	1034
Магнетизм кристаллов $A^{III}B^V$, легированных редкими землями. Н.Т. Баграев, В.В. Романов	10	1173
Some Aspects to the RHEED Behaviour of LT-GaAs Growth. Ákos Nemesics	11	1398
Электронный обмен между нейтральными и ионизированными центрами германия в PbSe. И.Е. Теруков, Э.С. Хужакулов	12	1420

4.1.5. Физические эффекты, связанные с облучением. Радиационные дефекты (PACS 61.80)

Варизонный фотоэлектрический детектор ионизирующего излучения. Л. Дапкус, К. Пожела, Ю. Пожела, А. Шилленас, В. Юцене, В. Ясутис	2	281
--	---	-----

Накопление радиационных дефектов в арсениде галлия при импульсном и непрерывном облучении ионами. М.В. Ардышев, В.М. Ардышев, Ю.Ю. Крючков	3	313
Электрофизические и оптические свойства InAs, облученного электронами (~ 2 МэВ): энергетическая структура собственных точечных дефектов. В.Н. Брудный, С.Н. Гриняев, Н.Г. Колин	4	409
Влияние зарядового состояния неравновесных вакансий на природу радиационных дефектов в кристаллах $n-Si$. Т.А. Пагава	4	424
Электрофизические и оптические свойства InP, облученного большими интегральными потоками нейтронов. В.Н. Брудный, Н.Г. Колин, Д.И. Меркурисов, В.А. Новиков	5	528
Влияние нейтронного облучения на свойства нитевидных микрокристаллов $n-InSb$. И.А. Большакова, В.М. Бойко, В.Н. Брудный, И.В. Каменская, Н.Г. Колин, Е.Ю. Макидо, Т.А. Московец, Д.И. Меркурисов	7	814
Наноструктурирование кристаллических зерен природного алмаза ионизирующим излучением. Н.А. Поклонский, Т.М. Лапчук, Н.И. Горбачук, В.А. Николаенко, И.В. Бачучин	8	931
Образование наноразмерных структур на поверхности кристаллов $p-CdTe$ при однократном воздействии импульсом излучения рубинового лазера. А. Байдуллаева, А.И. Власенко, Л.Ф. Кузан, О.С. Литвин, П.Е. Мозоль	9	1064
Стабилизация заряда на границе со скрытым диэлектриком структур кремний-на-изоляторе. И.В. Антонова	10	1195
Динамика лазерно-индуцированных фазовых переходов в теллуриде кадмия. А.А. Ковалев, С.П. Жвабый, Г.Л. Зыков	11	1345
Измерения длин диффузии микрометрового диапазона техникой ядерной спектрометрии. Н.Б. Строкан, А.М. Иванов, А.А. Лебедев, М. Suväjärv, R. Yakimova	12	1443

4.2. Механические и акустические свойства (PACS 62). Динамика решетки (PACS 63)

Расчет состояний мелких доноров в квантовых ямах в магнитном поле методом разложения по плоским волнам. В.Я. Алешкин, Л.В. Гавриленко	1	63
Влияние локализации в квантовой яме на время жизни состояний мелких примесных центров. Е.Е. Орлова, P. Harrison, W.-M. Zheng, M.P. Halsall	1	67
Внутреннее трение в полупроводниковых тонких пленках, полученных методом золь-гель технологии. А.С. Ильин, А.И. Максимов, В.А. Мошников, Н.П. Ярославцев	3	300
Spectroscopic parameters of LVM absorption bands of carbon and oxygen impurities in isotopic enriched silicon ^{28}Si , ^{29}Si and ^{30}Si . P.G. Sennikov, T.V. Kotereva, A.G. Kurganov, B.A. Andreev, H. Niemann, D. Schiel, V.V. Emtsev, H.-J. Pohl	3	320
Резонансные состояния доноров в квантовых ямах. Н.А. Беккин	4	463

Рассеяние фононов, управление термоэде и теплопроводностью в эвтектической композиции полупроводник–металл. Г.И. Исаков	7	772	Исследование способов получения и свойств квантовых молекул InAs в матрице GaAs. Ю.Б. Самсоненко, Г.Э. Цырлин, А.А. Тонких, Н.К. Поляков, Н.В. Крыжановская, В.М. Устинов, Л.Е. Воробьев, Д.А. Фирсов, В.А. Шальгин, N.D. Zakharov, P. Werner, A. Andreev	1	136
Исследование механических напряжений в селективно-оксидированных структурах GaAs/(AlGa) _x O _y . С.А. Блохин, А.Н. Смирнов, А.В. Сахаров, А.Г. Гладышев, Н.В. Крыжановская, Н.А. Малеев, А.Е. Жуков, Е.С. Семенова, Д.А. Бедарев, Е.В. Никитина, М.М. Кулагина, М.В. Максимов, Н.Н. Леденцов, В.М. Устинов	7	782	Влияние лазерного излучения на формирование ориентированных слоев сульфида кадмия в резко неравновесных условиях. А.П. Беляев, В.П. Рубец, В.В. Антипов	2	204
4.3. Фазовые равновесия и фазовые переходы (PACS 64)			Оптические свойства пористого наноразмерного GaAs. А.И. Белогорохов, С.А. Гаврилов, И.А. Белогорохов, А.А. Тихомиров	2	258
Электрофизические характеристики макросистем диэлектрик–проводник, диэлектрик–полупроводник. В.А. Соцков	2	269	Сенсоры аммиака на основе диодов Pd–n-Si. В.И. Баллоба, В.Ю. Грицык, Т.А. Давыдова, В.М. Калыгина, С.С. Назаров, Л.С. Хлудкова	2	285
Термодинамическая стабильность и перераспределение зарядов в тройных твердых растворах нитридов элементов III группы. В.Г. Дейбук, А.В. Возный	6	655	Вакансионная модель процесса гетерополитипной эпитаксии SiC. А.А. Лебедев, С.Ю. Давыдов	3	296
4.4. Термические свойства (PACS 65). Диффузия и теплопроводность (PACS 66)			Влияние диффузии Te из подложки n-GaSb:Te на свойства твердых растворов GaInAsSb, выращенных в присутствии свинца. Т.И. Воронина, Т.С. Лагунова, А.Ф. Липаев, Е.В. Куницына, Я.А. Пархоменко, М.А. Сиповская, Ю.П. Яковлев	3	327
Получение слоев VGaAs методом МОГФЭ на подложках GaAs. Д.А. Пряхин, В.М. Данильцев, Ю.Н. Дроздов, М.Н. Дроздов, Д.М. Гапонова, А.В. Мурель, В.И. Шашкин, S. Rushworth	1	17	Закон Вегарда и сверхструктурная фаза в эпитаксиальных гетероструктурах Al _{1-x} Ga _x As/GaAs(100). Э.П. Домашевская, П.В. Середин, Э.А. Долгополова, И.Е. Занин, И.Н. Арсентьев, Д.А. Винокуров, А.Л. Станкевич, И.С. Тарасов	3	354
Особенности эпитаксиального наращивания GaN при пониженном давлении в реакторе МОГФЭ. О.И. Хрыкин, А.В. Бутин, Д.М. Гапонова, В.М. Данильцев, М.Н. Дроздов, Ю.Н. Дроздов, А.В. Мурель, В.И. Шашкин	1	21	Atmospheric adsorption effects in hot wire chemical vapour deposition microcrystalline silicon films with different electrode configurations. S.K. Persheyev, V. Smirnov, K.A. O'Neill, S. Reynolds, M.J. Rose	3	361
Влияние уплотнения на люминесцентные свойства порошков ZnS:Ga. Ю.Ю. Бачериков, Н.В. Кицок, С.В. Оптасюк, А.А. Стадник	3	316	Роль примеси бора в активации свободных носителей заряда в слоях пористого кремния при адсорбции акцепторных молекул. Л.А. Осминкина, Е.А. Константинова, К.С. Шаров, П.К. Кашкаров, В.Ю. Тимошенко	3	365
Влияние диффузии Te из подложки n-GaSb:Te на свойства твердых растворов GaInAsSb, выращенных в присутствии свинца. Т.И. Воронина, Т.С. Лагунова, А.Ф. Липаев, Е.В. Куницына, Я.А. Пархоменко, М.А. Сиповская, Ю.П. Яковлев	3	327	Влияние адсорбции молекул пиридина на концентрацию свободных носителей заряда и спиновое центрование в слоях пористого кремния. Л.А. Осминкина, А.С. Воронцов, Е.А. Константинова, В.Ю. Тимошенко, П.К. Кашкаров	4	482
Оптическое поглощение и диффузия хрома в монокристаллах ZnSe. Ю.Ф. Вакман, В.В. Павлов, Ю.А. Ницук, Ю.Н. Пуртов, А.С. Насибов, П.В. Шапкин	4	401	Особенности формирования эпитаксиальных пленок на пористых подложках A ^{III} B ^V . А.А. Ситникова, А.В. Бобыль, С.Г. Конников, В.П. Улин	5	552
Причины устойчивости трехслойных островков и ступеней на поверхности Si(111). А.В. Зверев, И.Г. Неизвестный, И.А. Рейзвих, К.Н. Романюк, С.А. Тийс, Н.Л. Шварц, З.Ш. Яновицкая	8	1002	Пороговый характер формирования наноразмерных островков в системе Ge/Si(100) в присутствии сурьмы. Г.Э. Цырлин, В.Г. Дубровский, А.А. Тонких, Н.В. Сибирев, В.М. Устинов, P. Werner	5	577
4.5. Структура поверхностей, границ раздела и тонких пленок (PACS 68)			Диффузионный механизм роста нановискеров GaAs и AlGaAs в методе молекулярно-пучковой эпитаксии. Г.Э. Цырлин, В.Г. Дубровский, Н.В. Сибирев, И.П. Сошников, Ю.Б. Самсоненко, А.А. Тонких, В.М. Устинов	5	587
Влияние параметров процесса МОГФЭ на свойства эпитаксиальных пленок GaInAsN. В.М. Данильцев, Д.М. Гапонова, М.Н. Дроздов, Ю.Н. Дроздов, А.В. Мурель, Д.А. Пряхин, О.И. Хрыкин, В.И. Шашкин	1	13	Термодинамическая стабильность и перераспределение зарядов в тройных твердых растворах нитридов элементов III группы. В.Г. Дейбук, А.В. Возный	6	655
Особенности структурного взаимодействия в гетероструктурах (AlGaIn)N/GaN как дислокационных фильтров. И.П. Сошников, Н.Н. Леденцов, А.Ф. Цацульников, А.В. Сахаров, В.В. Лундин, Е. Заварин, А.В. Фомин, D. Litvinov, E. Hahn, D. Gerthsen	1	112	Влияние адсорбированных молекул на спектр носителей в полупроводниковом нанопроводе. В.А. Лыках, Е.С. Сыркин	6	710

- Переход от термодинамического режима формирования квантовых точек в системе InAs/GaAs(100) к кинетическому. Ю.Г. Мусихин, Г.Э. Цырлин, В.Г. Дубровский, Ю.Б. Самсоненко, А.А. Тонких, Н.А. Берт, В.М. Устинов 7 853
- Characterization of *a*-Si:H/*c*-Si interface by admittance spectroscopy. A.S. Gudovskikh, J.-P. Kleider, E.I. Terukov 8 940
- Причины устойчивости трехслойных островков и ступеней на поверхности Si(111). А.В. Зверев, И.Г. Неизвестный, И.А. Рейвих, К.Н. Романюк, С.А. Тийс, Н.Л. Шварц, З.Ш. Яновицкая 8 1002
- Микрофотолуминесценция нелегированного монокристаллического теллурида цинка, полученного неравновесными парофазными методами. В.В. Ушаков, Ю.В. Клевков 9 1029
- Кинетика роста тонких пленок при зародышевом механизме формирования слоев. В.Г. Дубровский, Г.Э. Цырлин 11 1312
- Десорбция водорода с поверхности в условиях эпитаксиального наращивания слоев кремния из моносилана в вакууме. Л.К. Орлов, Т.Н. Смыслова 11 1320
- Адсорбция, десорбция, контактная и термическая трансформация молекул C₆₀ на поверхности Ta(100). Н.Р. Галль, Е.В. Рутков, А.Я. Тонтегоде 11 1325
- Динамика лазерно-индуцированных фазовых переходов в теллуриде кадмия. А.А. Ковалев, С.П. Жвабый, Г.Л. Зыков 11 1345
- Роль исходного легирования в эффекте изменения концентрации носителей заряда в пористом кремнии при адсорбции молекул аммиака. А.В. Павликов, Л.А. Осминкина, И.А. Белогорохов, Е.А. Константинова, А.И. Ефимова, В.Ю. Тимошенко, П.К. Кашкаров 11 1384
- Удаление фторполимерных загрязнений с поверхности кремниевых структур при обработке в потоке атомарного водорода. Е.В. Анищенко, В.А. Кагадей, Е.В. Нефёдцев, Д.И. Проскуровский, С.В. Романенко 11 1388
- Мессбауэровское исследование двухэлектронных донорных центров германия в PbSe. Е.И. Теруков, Э.С. Хужакулов 12 1417
- 5. Электронная структура, электрические, магнитные и оптические свойства (PACS 70)**
- Исследование центров рекомбинации, связанных с наноразмерными кластерами As-Sb в низкотемпературном арсениде галлия. П.Н. Брунков, А.А. Гуткин, Ю.Г. Мусихин, В.В. Чалдышев, Н.Н. Берт, С.Г. Конников, В.В. Преображенский, М.А. Путьято, Б.Р. Семягин 1 41
- 5.1. Электронные состояния (PACS 71)**
- Долговременная кинетика фотолуминесценции квантовых точек InAs/AlAs в магнитном поле. Т.С. Шамирзаев, А.М. Гилинский, А.К. Бакаров, А.И. Торопов, С.А. Фигуренко, К.С. Журавлев 1 35
- Локализация дырок в квантовой молекуле InAs/GaAs. М.М. Соболев, Г.Э. Цырлин, Ю.Б. Самсоненко, Н.К. Поляков, А.А. Тонких, Ю.Г. Мусихин 1 131
- Ab initio* studies of band parameters of A^{III}B^V and A^{II}B^{VI} zinc-blende semiconductors. S.Zh. Karazhanov, L.C. Lew Yan Voon 2 177
- Исследование активации примеси в InP, имплантированном ионами бериллия, методом фотоотражения. Л.П. Авакянц, П.Ю. Боков, А.В. Червяков 2 189
- Спектроскопия германия, легированного Ga, при одноосном сжатии. Я.Е. Покровский, Н.А. Хвальковский 2 197
- Электрофизические характеристики макросистем диэлектрик-проводник, диэлектрик-полупроводник. В.А. Соцков 2 269
- Статистика электронов в PbS с U-центрами. С.А. Немов, Ф.С. Насрединов, П.П. Серегин, Н.П. Серегин, Э.С. Хужакулов 3 309
- Модель для описания рассеяния дырок на гетерограницах GaAs/AlAs(001). Г.Ф. Каравасв, В.Н. Чернышов 3 336
- Плотность состояний в щели подвижности аморфного гидрированного кремния, легированного эрбием. А.В. Бирюков, А.Г. Казанский, Е.И. Теруков, К.Ю. Хабарова 3 369
- Анизотропия эффективной массы Г-электронов в квантовой яме GaAs/(AlGa)As. Е.Е. Вдовин, Ю.Н. Ханин 4 445
- Влияние кислорода на электронную зонную структуру ZnS. Н.К. Морозова, И.А. Каретников, К.В. Голуб, Н.Д. Данилевич, В.М. Лисицын, В.И. Олешко 5 513
- Проводимость и эффект Холла в CdF₂:In и CdF₂:Y. И.И. Сайдашев, Е.Ю. Перлин, А.И. Рыскин, А.С. Щеулин 5 535
- Токи инжекции в узкозонном диэлектрике Pb_{1-x}Sn_xTe(In). А.Н. Акимов, В.Г. Ерков, А.Э. Климов, Е.Л. Молодцова, С.П. Супрун, В.Н. Шумский 5 563
- Влияние температуры вакуумного отжига на край фундаментального поглощения и структурную релаксацию пленок *a*-SiC:H. А.В. Васин, А.В. Русавский, В.С. Лысенко, А.Н. Назаров, В.И. Кушниренко, С.П. Старик, В.Г. Степанов 5 602
- Энергетические параметры двухэлектронных центров олова в PbSe. С.А. Немов, Ф.С. Насрединов, П.П. Серегин, Н.П. Серегин, Э.С. Хужакулов 6 669
- Неомическая прыжковая квазидвумерная проводимость и кинетика ее релаксации. Б.А. Аронзон, Д.Ю. Ковалев, В.В. Рыльков 7 844
- Исследование локальной электронной и атомной структуры в аморфных сплавах *a*-Si_xC_{1-x} методом ультрамягкой рентгеновской спектроскопии. В.А. Терехов, Е.И. Теруков, И.Н. Трапезникова, В.М. Кашкаров, О.В. Курило, С.Ю. Туришев, А.Б. Голоденко, Э.П. Домашевская 7 863
- Исследование углеродной структуры композитных пленок *a*-C:H(Cu) и *a*-C:H(Co) методом рамановской спектроскопии. Э.А. Сморгонская, В.И. Иванов-Омский 8 970
- Структурные преобразования и оптические свойства халькогенидных стекол As₂S₃. И.В. Фекешгази, К.В. Май, Н.И. Мателешко, В.М. Мица, Е.И. Боркач 8 986

- Обратимые фотондуцированные изменения в спектре локализованных состояний в пленках AsSe. Л.П. Казакова, К.Д. Цэндин, М.А. Тагирджанов, Н.С. Аверкиев 8 998
- Неустойчивость дрейфовых волн в двухкомпонентной твердотельной плазме. А.А. Булгаков, О.В. Шрамкова 9 1043
- Электронное строение наноструктур дисульфида титана: монослои, наноленты, нанотрубки. В.В. Ивановская, Г. Зейферт, А.Л. Ивановский 9 1093
- Экситонные состояния в полупроводниковых сферических наноструктурах. С.И. Покутний 9 1101
- Термодинамическая устойчивость объемных и эпитаксиальных твердых растворов CdHgTe, ZnHgTe, MnHgTe. В.Г. Дейбук, С.Г. Дремлюженко, С.Э. Остапов 10 1153
- Магнетизм кристаллов $A^{III}B^V$, легированных редкими землями. Н.Т. Баграев, В.В. Романов 10 1173
- Формирование потенциальных барьеров в нелегированных неупорядоченных полупроводниках. Н.В. Вишняков, С.П. Вихров, В.Г. Мишустин, А.П. Авачев, И.Г. Уточкин, А.А. Попов 10 1189
- Спиновое расщепление примесных состояний доноров, связанных с X-долиной в AlAs-барьере, и пространственное распределение плотности вероятности их волновых функций. Е.Е. Вдовин, Ю.Н. Ханин 10 1204
- Фотолюминесценция кремниевых нанокристаллов под действием электрического поля. Е.Н. Вандышев, А.М. Гишинский, Т.С. Шамирзаев, К.С. Журавлев . 11 1365
- 5.1.1. Уровни дефектов и примесей (PACS 71.55)**
- Расчет состояний мелких доноров в квантовых ямах в магнитном поле методом разложения по плоским волнам. В.Я. Алешкин, Л.В. Гавриленко 1 63
- Влияние локализации в квантовой яме на время жизни состояний мелких примесных центров. Е.Е. Орлова, P. Harrison, W.-M. Zheng, M.P. Halsall 1 67
- Статистика электронов в PbS с U-центрами. С.А. Немов, Ф.С. Насрединов, П.П. Серегин, Н.П. Серегин, Э.С. Хужакулов 3 309
- Spectroscopic parameters of LVM absorption bands of carbon and oxygen impurities in isotopic enriched silicon ^{28}Si , ^{29}Si and ^{30}Si . P.G. Sennikov, T.V. Kotereva, A.G. Kurganov, B.A. Andreev, H. Niemann, D. Schiel, V.V. Emtsev, H.-J. Pohl 3 320
- Электрофизические и оптические свойства InAs, облученного электронами ($\sim 2\text{ МэВ}$): энергетическая структура собственных точечных дефектов. В.Н. Брудный, С.Н. Гриняев, Н.Г. Колин 4 409
- Влияние зарядового состояния неравновесных вакансий на природу радиационных дефектов в кристаллах n-Si. Т.А. Пагава 4 424
- Особенности электропроводности легированных пленок $\alpha\text{-Si:H}$ с нанокристаллами кремния. С.А. Аржанникова, М.Д. Ефремов, Г.Н. Камаев, А.В. Вишняков, В.А. Володин 4 472
- Влияние кислорода на электронную зонную структуру ZnS. Н.К. Морозова, И.А. Каретников, К.В. Голуб, Н.Д. Данилевич, В.М. Лисицын, В.И. Олешко 5 513
- Определение концентрации глубоких уровней в полупроводниковых монокристаллах CdS методом фотоэлектрической нестационарной спектроскопии. А.П. Одринский 6 660
- Энергетические параметры двухэлектронных центров олова в PbSe. С.А. Немов, Ф.С. Насрединов, П.П. Серегин, Н.П. Серегин, Э.С. Хужакулов 6 669
- Физические свойства CdTe при совместном легировании V и Ge. С.Ю. Паранчич, Л.Д. Паранчич, В.Н. Макогоненко, Ю.В. Танасюк, М.Д. Андрийчук, В.Р. Романюк 6 744
- Водородсодержащие доноры в кремнии — центры с отрицательной эффективной корреляционной энергией. Ю.М. Покотило, А.Н. Петух, В.В. Литвинов, В.Г. Цвирко 7 802
- Магнитные свойства аморфного углерода, модифицированного железом. С.Г. Ястребов, В.И. Иванов-Омский, В. Поп, К. Морошану, А. Слав, Ж. Волрон . 7 874
- Фотондуцированная релаксация метастабильных состояний в $\alpha\text{-Si:H (В)}$. Н.Н. Ормонт, И.А. Курова, Г.В. Прокофьев 8 960
- Влияние эрбия и кислорода на интенсивность фотолюминесценции эрбия и состав пленок $\alpha\text{-SiO}_x\text{:H (Er,O)}$, полученных магнетронным распылением на постоянном токе. Ю.К. Ундалов, Е.И. Теруков, О.Б. Гусев, В.Х. Кудоярова 8 979
- Свойства аморфных пленок халькогенидов мышьяка, модифицированных комплексными соединениями редкоземельных элементов. С.А. Козюхин, А.Р. Файрушин, Э.Н. Воронков 8 1012
- Спиновое расщепление примесных состояний доноров, связанных с X-долиной в AlAs-барьере, и пространственное распределение плотности вероятности их волновых функций. Е.Е. Вдовин, Ю.Н. Ханин 10 1204
- Применимость упрощенной модели Шокли–Рида–Холла для полупроводников с различными типами дефектов. А.Н. Яшин 11 1331
- Электронный обмен между нейтральными и ионизированными центрами германия в PbSe. И.Е. Теруков, Э.С. Хужакулов 12 1420
- 5.2. Транспортные явления (PACS 72)**
- Свойства структур на основе GaAs, легированного Mn из лазерной плазмы в процессе МОС-гидридной эпитаксии. Ю.В. Васильева, Ю.А. Данилов, Ант.А. Ершов, Б.Н. Звонков, Е.А. Ускова, А.Б. Давыдов, Б.А. Аронзон, С.В. Гуденко, В.В. Рыльков, А.Б. Грановский, Е.А. Ганьшина, Н.С. Перов, А.Н. Виноградов 1 87
- Спиновые эффекты в индуцированном параллельном магнитным полем магнитосопротивлении двойной квантовой ямы $n\text{-In}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As/GaAs}$. М.В. Якунин, Г.А. Альшанский, Ю.Г. Арапов, В.Н. Неверов, Г.И. Харус, Н.Г. Шелушина, Б.Н. Звонков, Е.А. Ускова, А. де Виссер, Л. Пономаренко 1 118

- Влияние импульсного токового отжига на электрофизические характеристики поликристаллического кремния *p*-типа. В.А. Гридчин, В.М. Любимский . . . 2 192
- Рассеяние носителей заряда на границах кристаллитов в пленках поликристаллического кремния. В.А. Гридчин, В.М. Любимский, А.Г. Моисеев . . . 2 208
- Квазиклассическое рассмотрение осцилляций электропроводности слоистых кристаллов в магнитном поле при рассеянии носителей тока на акустических фононах. П.В. Горский 3 343
- Механизмы протекания тока и фоточувствительность структур *n*-ZnO:Al/CuPc/*p*-Cu(In,Ga)Se₂. Г.А. Ильчук, С.Е. Никитин, Ю.А. Николаев, В.Ю. Рудь, Ю.В. Рудь, Е.И. Теруков 3 349
- Atmospheric adsorption effects in hot wire chemical vapour deposition microcrystalline silicon films with different electrode configurations. S.K. Persheyev, V. Smirnov, K.A. O'Neill, S. Reynolds, M.J. Rose . . . 3 361
- Плотность состояний в щели подвижности аморфного гидрированного кремния, легированного эрбием. А.В. Бирюков, А.Г. Казанский, Е.И. Теруков, К.Ю. Хабарова 3 369
- Анизотропия эффективной массы Γ -электронов в квантовой яме GaAs/(AlGa)As. Е.Е. Вдовин, Ю.Н. Ханин 4 445
- Моделирование электрических свойств поликристаллических керамических полупроводников с субмикрометровыми размерами зерен. И.В. Рожанский, Д.А. Закгейм 5 608
- Определение концентрации глубоких уровней в полупроводящих монокристаллах CdS методом фотоэлектрической нестационарной спектроскопии. А.П. Одринский 6 660
- Поведение структурных дефектов и проводимости в легированных бором пленках *nc*-SiC:H, выращенных методом photo-CVD. О.И. Шевалесевский, S.Y. Myong, K.S. Lim, S. Miyajima, M. Konagai 6 741
- Рассеяние фононов, управление термоэдэ и теплопроводностью в эвтектической композиции полупроводник—металл. Г.И. Исаков 7 772
- Влияние нейтронного облучения на свойства нитевидных микрокристаллов *n*-InSb. И.А. Большакова, В.М. Бойко, В.Н. Брудный, И.В. Каменская, Н.Г. Колин, Е.Ю. Макидо, Т.А. Московец, Д.И. Меркурисов 7 814
- Оптические и электрические свойства тонких пластин, изготовленных из нанокристаллических порошков кремния. Н.Н. Кононов, Г.П. Кузьмин, А.Н. Орлов, А.А. Сурков, О.В. Тихоневич 7 868
- Магнитные свойства аморфного углерода, модифицированного железом. С.Г. Ястребов, В.И. Иванов-Омский, В. Поп, К. Моршану, А. Слав, Ж. Волрон . . . 7 874
- Свойства аморфных пленок халькогенидов мышьяка, модифицированных комплексными соединениями редкоземельных элементов. С.А. Козюхин, А.Р. Файрушин, Э.Н. Воронков 8 1012
- Точная самокомпенсация проводимости в кристалле Cd_{0,95}Zn_{0,05}Te:Cl в широком интервале давлений пара Cd. О.А. Матвеев, А.И. Терентьев, Н.К. Зеленина, В.Н. Гуськов, В.Е. Седов, А.А. Томасов, В.П. Карпенко 9 1034
- 5.2.1. Явления электронной проводимости в полупроводниках (PACS 72.20)**
- Спиновые эффекты в индуцированном параллельным магнитным полем магнитосопротивлении двойной квантовой ямы *n*-In_{*x*}Ga_{1-*x*}As/GaAs. М.В. Якунин, Г.А. Альшанский, Ю.Г. Арапов, В.Н. Неверов, Г.И. Харус, Н.Г. Шелушинина, Б.Н. Звонков, Е.А. Ускова, А. де Виссер, Л. Пономаренко 1 118
- Влияние импульсного токового отжига на электрофизические характеристики поликристаллического кремния *p*-типа. В.А. Гридчин, В.М. Любимский . . . 2 192
- Влияние нелинейной электромагнитной волны на плотность тока в поверхностной сверхрешетке в сильном электрическом поле. Д.В. Завьялов, С.В. Крючков, Н.Е. Мещерякова 2 214
- Неомическая проводимость и механизмы релаксации энергии 2D электронного газа в гетероструктурах GaAs/InGaAs/GaAs. А.А. Шерстобитов, Г.М. Миньков, О.Э. Рут, А.В. Германенко, Б.Н. Звонков 2 237
- Особенности межэлектронного взаимодействия в потенциальной яме сильно легированного гетероперехода Al_{*x*}Ga_{1-*x*}As(Si)/GaAs. В.И. Кадушкин 2 242
- Влияние диффузии Te из подложки *n*-GaSb:Te на свойства твердых растворов GaInAsSb, выращенных в присутствии свинца. Т.И. Воронина, Т.С. Лагунова, А.Ф. Липасев, Е.В. Куницына, Я.А. Пархоменко, М.А. Сиповская, Ю.П. Яковлев . . 3 327
- Электрофизические и оптические свойства InAs, облученного электронами (~ 2 МэВ): энергетическая структура собственных точечных дефектов. В.Н. Брудный, С.Н. Гриняев, Н.Г. Колин 4 409
- Электрофизические и оптические свойства InP, облученного большими интегральными потоками нейтронов. В.Н. Брудный, Н.Г. Колин, Д.И. Меркурисов, В.А. Новиков 5 528
- Токи инжекции в узкозонном диэлектрике Pb_{1-*x*}Sn_{*x*}Te(In). А.Н. Акимов, В.Г. Ерков, А.Э. Климов, Е.Л. Молодцова, С.П. Супрун, В.Н. Шумский . . 5 563
- Определение концентрации носителей заряда в поликристаллических слоях селенида свинца на основе спектров отражения. А.Е. Гамарц, Ю.М. Канагеева, В.А. Мошников 6 667
- Рекомбинационный механизм пьезофоторезистивного эффекта в компенсированных полупроводниках. Б.М. Павлишенко, Р.Я. Шувар 6 689
- Влияние адсорбированных молекул на спектр носителей в полупроводниковом нанопроводе. В.А. Лыках, Е.С. Сыркин 6 710
- Низкотемпературные нестабильности электрических свойств полупроводящих кристаллов Cd_{0,96}Zn_{0,04}Te:Cl. А.В. Савицкий, О.А. Парфенюк, М.И. Илащук, К.С. Уляницкий, С.Н. Чупыра, Н.Д. Вахняк 7 788
- Отрицательное магнитосопротивление в кремнии, легированном бором и марганцем, стимулированное электрическим полем и светом. М.К. Бахадырханов, О.Э. Саттаров, Х.М. Илиев, К.С. Аюпов, Туэрди Умайер 7 823
- Резонансная модуляция электрон-электронной релаксации квантующим магнитным полем. В.И. Кадушкин 7 859

- Обратимые фотондуцированные изменения в спектре локализованных состояний в пленках AsSe. Л.П. Казакова, К.Д. Цэндин, М.А. Тагирджанов, Н.С. Аверкиев 8 998
- Ловушки для электронов в тонких слоях низкотемпературного арсенида галлия с наноразмерными кластерами As—Sb. П.Н. Брунков, А.А. Гуткин, В.В. Чалдышев, Н.Н. Берт, С.Г. Конников, В.В. Преображенский, М.А. Путьато, Б.Р. Семягин . 9 1049
- Исследование свойств $\text{Hg}_{1-x-y-z}\text{Cd}_x\text{Mn}_y\text{Zn}_z\text{Te}$ как нового материала оптоэлектроники для инфракрасного диапазона. И.Н. Горбатов, С.Э. Остапов, С.Г. Дремлюженко, Р.А. Заплитный, И.М. Фодчук, В.В. Жихаревич, В.Г. Дейбук, Н.А. Поленко, И.В. Иванченко, А.А. Жигалов, С.Ю. Карелин . . . 9 1053
- Кинетические коэффициенты $n\text{-Bi}_2\text{Te}_{2.7}\text{Se}_{0.3}$ в двухзонной модели электронного спектра. П.П. Константинов, Л.В. Прокофьева, М.И. Федоров, Д.А. Пшенай-Северин, Ю.И. Равич, В.В. Компаниец, В.А. Чистяков 9 1059
- Низкотемпературное микроволновое магнитосопротивление слабо легированных $p\text{-Ge}$ и сплава $p\text{-Ge}_{1-x}\text{Si}_x$. А.И. Вейнгер, А.Г. Забродский, Т.В. Тиснек 10 1159
- Исследование свойств двумерного электронного газа в гетероструктурах $p^-\text{-3C-SiC}/n^+\text{-6H-SiC}$ при низких температурах. А.А. Лебедев, Д.К. Нельсон, Б.С. Разбирин, И.И. Сайдашев, А.Н. Кузнецов, А.Е. Черенков 10 1236
- 5.2.2. Высокочастотные эффекты и эффекты обусловленные плазмой (PACS 72.30)**
- Resonant terahertz response of a slot diode with a two-dimensional electron channel. V.V. Popov, G.M. Tsybalov, M.S. Shur, W. Knapp 1 157
- Блоховские колебания в сверхрешетках. Проблема терагерцового генератора. Ю.А. Романов, Ю.Ю. Романова 1 162
- Транспортные и термоэлектрические свойства полупроводникового силицида рения. А.Б. Филонов, А.Е. Кривошеев, Л.И. Иваненко, Г. Бер, И. Шумани, Д. Суптель, В.Е. Борисенко 4 419
- Динамический хаос в частично освещенном компенсированном полупроводнике в условиях примесного электрического пробоя. К.М. Джандиери, З.С. Качлишвили, А.Б. Стрганов 6 673
- 5.2.3. Фотопроводимость и фотовольтаический эффект (PACS 72.40)**
- Спектры остаточной фотопроводимости в гетероструктурах InAs/AlSb с квантовыми ямами. В.Я. Алешкин, В.И. Гавриленко, Д.М. Гапонова, А.В. Иконников, К.В. Маремьянин, С.В. Морозов, Ю.Г. Садофьев, S.R. Johnson, Y.-H. Zhang 1 30
- Электролюминесцентные свойства гетероструктур с квантовыми ямами GaInNAs. А.В. Мурель, В.М. Данильцев, Ю.Н. Дроздов, Д.М. Гапонова, В.И. Шашкин, В.Б. Шмагин, О.И. Хрыкин 1 38
- Спектроскопия германия, легированного Ga, при одноосном сжатии. Я.Е. Покровский, Н.А. Хвальковский 2 197
- Получение и фотоэлектрические свойства гетеропереходов ZnO-Cu(In,Ga)Se_2 . В.Ф. Гременок, Г.А. Ильчук, С.Е. Никитин, В.Ю. Рудь, Ю.В. Рудь . 2 218
- Влияние диффузии Te из подложки $n\text{-GaSb}$: Te на свойства твердых растворов GaInAsSb, выращенных в присутствии свинца. Т.И. Воронина, Т.С. Лагунова, А.Ф. Липаев, Е.В. Куницына, Я.А. Пархоменко, М.А. Сиповская, Ю.П. Яковлев . 3 327
- Механизмы протекания тока и фоточувствительность структур $n\text{-ZnO:Al/CuPc}/p\text{-Cu(In,Ga)Se}_2$. Г.А. Ильчук, С.Е. Никитин, Ю.А. Николаев, В.Ю. Рудь, Ю.В. Рудь, Е.И. Торуков 3 349
- Фотопреобразование в структурах $n\text{-ZnO:Al/PdPc}/p\text{-CuIn}_3\text{Ses}$. И.В. Боднар, Е.С. Дмитриева, С.Е. Никитин, В.Ю. Рудь, Ю.В. Рудь, Е.И. Торуков . 4 426
- Получение и фотоэлектрические свойства структур $n\text{-ZnO:Al/PdPc}/p\text{-Si}$. Г.А. Ильчук, С.Е. Никитин, Ю.А. Николаев, В.Ю. Рудь, Ю.В. Рудь, Е.И. Торуков 4 433
- Примесная фотопроводимость халькогенов в твердых растворах $\text{Ge}_{1-x}\text{Si}_x$. Н.Б. Радчук, А.Ю. Ушаков . . 5 550
- Влияние одноосного сжатия на параметры фотообразования оптического контакта $p\text{-GaSe-n-InSe}$. С.И. Драпак, М.О. Воробец, З.Д. Ковалюк 5 633
- Определение концентрации глубоких уровней в полупроводниках монокристаллах CdS методом фотоэлектрической нестационарной спектроскопии. А.П. Одринский 6 660
- Рекомбинационный механизм пьезофоторезистивного эффекта в компенсированных полупроводниках. Б.М. Павлишенко, Р.Я. Шувар 6 689
- Свойства структур на основе окисленного пористого кремния при воздействии освещения и газовых сред. Д.И. Биленко, О.Я. Белобровая, Э.А. Жаркова, Д.В. Терин, Е.И. Хасина 7 834
- Особенности физического дифференцирования по коэффициенту поглощения света в спектрах вентильной фотоэде. Л.И. Бережинский, Е.Ф. Венгер, И.Е. Матяш, А.В. Саченко, Б.К. Сердега 10 1164
- Структурные механизмы оптимизации фотоэлектрических свойств пленочных гетеросистем CdS/CdTe. Г.С. Хрипунов 10 1266
- 5.3. Электронная структура и электрические свойства поверхностей, границ раздела и тонких пленок (PACS 73)**
- Исследование центров рекомбинации, связанных с наноразмерными кластерами As—Sb в низкотемпературном арсениде галлия. П.Н. Брунков, А.А. Гуткин, Ю.Г. Мусихин, В.В. Чалдышев, Н.Н. Берт, С.Г. Конников, В.В. Преображенский, М.А. Путьато, Б.Р. Семягин 1 41
- Влияние электрохимической модификации тонкого покровного слоя Ga(In)As на энергетический спектр квантовых точек InAs/GaAs. И.А. Карпович, А.В. Здравейцев, С.В. Тихов, П.Б. Демина, О.Е. Хапутин 1 45
- Междолинное поглощение света в гетероструктурах с двойными туннельно-связанными квантовыми ямами GaAs/AlGaAs. Л.Е. Воробьев, В.Ю. Паневин, Н.К. Федосов, Д.А. Фирсов, В.А. Шалыгин, В.В. Капаев, S. Hanna, S. Schmidt, E.A. Zibik, A. Seilmeyer 1 49

- Оптические явления в гетероструктурах InAs/GaAs с легированными квантовыми точками и искусственными молекулами. Л.Е. Воробьев, В.Ю. Паневин, Н.К. Федосов, Д.А. Фирсов, В.А. Шальгин, A.D. Andreev, Ю.Б. Самсоненко, А.А. Тонких, Г.Э. Цырлин, Н.В. Крыжановская, В.М. Устинов, S. Hanna, A. Seilmeyer, N.D. Zakharov, P. Werner . . . 1 59
- Циклотронный резонанс в легированных и нелегированных гетероструктурах InAs/AlSb с квантовыми ямами. В.Я. Алешкин, В.И. Гавриленко, А.В. Иконников, Ю.Г. Садофьев, J.P. Bird, S.R. Johnson, Y.-H. Zhang . . . 1 71
- Свойства структур на основе GaAs, легированного Mn из лазерной плазмы в процессе МОС-гидридной эпитаксии. Ю.В. Васильева, Ю.А. Данилов, Ант.А. Ершов, Б.Н. Звонков, Е.А. Ускова, А.Б. Давыдов, Б.А. Аронзон, С.В. Гуденко, В.В. Рыльков, А.Б. Грановский, Е.А. Ганьшина, Н.С. Перов, А.Н. Виноградов . . . 1 87
- Гетероструктуры InGaAs/GaAs с квантовыми точками для инфракрасных фотоприемников диапазона 3–5 мкм. А.В. Антонов, Д.М. Гапонова, В.М. Данильцев, М.Н. Дроздов, Л.Д. Молдавская, А.В. Мурель, В.С. Туловчиков, В.И. Шашкин . . . 1 96
- Исследование фотоэлектрических свойств квантовых точек Ge в матрице ZnSe на GaAs. И.Г. Неизвестный, С.П. Супрун, В.Н. Шумский . . . 1 100
- „Необычная“ остаточная фотопроводимость в квантовой яме InAs/AlSb. Ю.Г. Садофьев, A. Ramamoorthy, J.P. Bird, S.R. Johnson, Y.-H. Zhang . . . 1 106
- Латеральная фотопроводимость структур AlGaAs/InGaAs с квантовыми ямами и самоорганизующимися квантовыми точками при межзонной подсветке. О.А. Шегай, А.К. Бакаров, А.К. Калагин, А.И. Торопов . . . 1 115
- Локализация дырок в квантовой молекуле InAs/GaAs. М.М. Соболев, Г.Э. Цырлин, Ю.Б. Самсоненко, Н.К. Поляков, А.А. Тонких, Ю.Г. Мусихин . . . 1 131
- Resonant terahertz response of a slot diode with a two-dimensional electron channel. V.V. Popov, G.M. Tsybalov, M.S. Shur, W. Knap . . . 1 157
- Блоховские колебания в сверхрешетках. Проблема терагерцового генератора. Ю.А. Романов, Ю.Ю. Романова . . . 1 162
- Рассеяние носителей заряда на границах кристаллитов в пленках поликристаллического кремния. В.А. Гридчин, В.М. Любимский, А.Г. Моисеев . . . 2 208
- Влияние нелинейной электромагнитной волны на плотность тока в поверхностной сверхрешетке в сильном электрическом поле. Д.В. Завьялов, С.В. Крючков, Н.Е. Мещерякова . . . 2 214
- Люминесценция $\lambda = 6\text{--}9$ мкм многослойных структур на основе InAsSb. Н.В. Зотова, С.А. Карандашев, Б.А. Матвеев, М.А. Ремесный, Н.М. Стусь, Н.Г. Тараканова . . . 2 230
- Особенности межэлектронного взаимодействия в потенциальной яме сильно легированного гетероперехода $\text{Al}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}(\text{Si})/\text{GaAs}$. В.И. Кадушкин . . . 2 242
- О влиянии флуктуаций толщины на статическую электропроводность квантовой полупроводниковой проволоки. М.А. Рувинский, Б.М. Рувинский . . . 2 247
- Селективный перенос электрона между квантовыми точками под действием резонансного импульса. Л.А. Опенов, А.В. Цуканов . . . 2 251
- Кинетика и неоднородная инжекция носителей в нанослоях InGaN. Д.С. Сизов, В.С. Сизов, Е.Е. Заварин, В.В. Лундин, А.В. Фомин, А.Ф. Цацульников, Н.Н. Леденцов . . . 2 264
- Квазиклассическое рассмотрение осцилляций электропроводности слоистых кристаллов в магнитном поле при рассеянии носителей тока на акустических фононах. П.В. Горский . . . 3 343
- Механизмы протекания тока и фоточувствительность структур $n\text{-ZnO:Al/CuPc/p-Cu(In,Ga)Se}_2$. Г.А. Ильчук, С.Е. Никитин, Ю.А. Николаев, В.Ю. Рудь, Ю.В. Рудь, Е.И. Теруков . . . 3 349
- Роль примеси бора в активации свободных носителей заряда в слоях пористого кремния при адсорбции акцепторных молекул. Л.А. Осминкина, Е.А. Константинова, К.С. Шаров, П.К. Кашкаров, В.Ю. Тимошенко . . . 3 365
- Получение и фотоэлектрические свойства структур $n\text{-ZnO:Al/PdPc/p-Si}$. Г.А. Ильчук, С.Е. Никитин, Ю.А. Николаев, В.Ю. Рудь, Ю.В. Рудь, Е.И. Теруков . . . 4 433
- Эффекты пространственной повторяемости при интерференции электронных волн в полупроводниковых двумерных наноструктурах с параболическими квантовыми ямами. В.А. Петров, А.В. Никитин . . . 4 436
- Анизотропия эффективной массы Γ -электронов в квантовой яме GaAs/(AlGa)As. Е.Е. Вдовин, Ю.Н. Ханин . . . 4 445
- Квазигидродинамическое моделирование электропроводности селективно легированных наноразмерных слоистых структур и островковых пленок в сильных электрических полях. В.А. Гергель, Ю.В. Гуляев, В.А. Курбатов, М.Н. Якупов . . . 4 453
- Экситонная фотолюминесценция и вертикальный транспорт фотовозбужденных носителей в сверхрешетках CdSe/CdMgSe. И.И. Решина, С.В. Иванов, Д.Н. Мирлин, И.В. Седова, С.В. Сорокин . . . 4 456
- Резонансные состояния доноров в квантовых ямах. Н.А. Бекин . . . 4 463
- Особенности электропроводности легированных пленок $\alpha\text{-Si:H}$ с нанокристаллами кремния. С.А. Аржанникова, М.Д. Ефремов, Г.Н. Камасев, А.В. Вишняков, В.А. Володин . . . 4 472
- Влияние адсорбции молекул пиридина на концентрацию свободных носителей заряда и спиновых центров в слоях пористого кремния. Л.А. Осминкина, А.С. Воронцов, Е.А. Константинова, В.Ю. Тимошенко, П.К. Кашкаров . . . 4 482
- Исследование статистики носителей в светодиодных структурах InGaN/GaN. Д.С. Сизов, В.С. Сизов, Е.Е. Заварин, В.В. Лундин, А.В. Фомин, А.Ф. Цацульников, Н.Н. Леденцов . . . 4 492
- Влияние p -легирования активной области на температурную стабильность характеристик лазеров на InAs/GaAs-квантовых точках. И.И. Новиков, Н.Ю. Гордеев, Л.Я. Карачинский, М.В. Максимов, Ю.М. Шерняков, А.Р. Ковш, И.Л. Крестников, А.В. Кожухов, С.С. Михрин, Н.Н. Леденцов . . . 4 502

- Гетеропереходы $p^+-Si-n-CdF_2$. Н.Т. Баграев, Л.Е. Клячкин, А.М. Маляренко, А.И. Рыскин, А.С. Щеулин 5 557
- Резонансное туннелирование дырок в двубарьерных структурах с квантовыми точками InAs в центре квантовой ямы GaAs. Е.Н. Морозова, О.Н. Макаровский, В.А. Волков, Ю.В. Дубровский, L. Tuganska, E.E. Вдовин, A. Patań, L. Eaves, M. Henini 5 573
- Локальная туннельная спектроскопия кремниевых наноструктур. Н.Т. Баграев, А.Д. Буравлев, Л.Е. Клячкин, А.М. Маляренко, В. Гельхофф, Ю.И. Романов, С.А. Рыков 6 716
- Оптические переходы в квантованном цилиндрическом слое при наличии однородного электрического поля. В.А. Арутюнян, С.Л. Арутюнян, Г.О. Демирчян, Г.Ш. Петросян 7 839
- Неомическая прыжковая квазидвумерная проводимость и кинетика ее релаксации. Б.А. Аронзон, Д.Ю. Ковалев, В.В. Рьльков 7 844
- Резонансная модуляция электрон-электронной релаксации квантующим магнитным полем. В.И. Кадушкин 7 859
- Кулоновское блокирование проводимости пленок SiO_x при одноэлектронной зарядке кремниевой квантовой точки в составе цепочки электронных состояний. М.Д. Ефремов, Г.Н. Камаев, В.А. Володин, С.А. Аржанникова, Г.А. Качурин, С.Г. Черкова, А.В. Кретинин, В.В. Малютин-Бронская, Д.В. Марин 8 945
- Механизмы токопереноса и свойства гетероструктур $\alpha-SiC:H/c-Si$. А.А. Шерченков, Б.Г. Будагян, А.В. Мазуров 8 964
- Моделирование особенностей эффекта насыщения дрейфовой скорости в субмикронных кремниевых структурах. В.А. Гергель, Ю.В. Гуляев, М.Н. Якупов 9 1075
- Спиновый фильтр на квантовом точечном контакте в разбавленном магнитном полупроводнике. С.А. Игнатенко, В.Е. Борисенко 9 1083
- Смещение Штарка состояний дырок одиночных квантовых точек InAs/GaAs, выращенных на подложках (100) и (311)A GaAs. М.М. Соболев, Г.Э. Цырлин, Ю.Б. Самсоненко, Н.К. Поляков, А.А. Тонких 9 1088
- Экситонные состояния в полупроводниковых сферических наноструктурах. С.И. Покутний 9 1101
- Высокочастотный нелинейный отклик двухъямных наноструктур. В.Ф. Елесин, И.Ю. Катеев 9 1106
- Поляризация оптического излучения поляронного экситона в анизотропных квантовых точках. А.Ю. Маслов, О.В. Прошина 9 1111
- Комбинированная модель резонансно-туннельного диода. И.И. Абрамов, И.А. Гончаренко, Н.В. Коломейцева 9 1138
- Электронная структура и спектральные характеристики клатратов Si_{46} и Na_8Si_{46} . С.И. Курганский, Н.А. Борщ, Н.С. Переславцева 10 1218
- Неравновесный характер распределения носителей при комнатной температуре в квантовых точках InAs, покрытых тонкими слоями AlAs/InAlAs. Н.В. Крыжановская, А.Г. Гладышев, С.А. Блохин, М.В. Максимов, Е.С. Семенова, А.П. Васильев, А.Е. Жуков, Н.Н. Леденцов, В.М. Устинов, Д. Бимберг 10 1230
- Исследование электронного спектра структур с квантовыми точками InGaN с помощью спектроскопии фототока. Д.С. Сизов, В.С. Сизов, В.В. Лундин, А.Ф. Цацульников, Е.Е. Заварин, Н.Н. Леденцов . . 11 1350
- Межзонное поглощение света в размерно-ограниченных системах в однородном электрическом поле. Э.П. Синявский, С.М. Соковнич, Р.А. Хамидуллин . 11 1359
- Циркулярная поляризация люминесценции, обусловленная током в квантовых ямах. Н.С. Аверкиев, А.Ю. Силов 11 1370
- Люминесценция и электропроводность полиамидокислоты и ее металл-полимерных комплексов с La и Tb. Э.А. Лебедев, М.Я. Гойхман, Д.М. Жигунов, И.В. Подешво, В.В. Кудрявцев, В.Ю. Тимошенко . . 11 1379
- Роль исходного легирования в эффекте изменения концентрации носителей заряда в пористом кремнии при адсорбции молекул аммиака. А.В. Павликов, Л.А. Осминкина, И.А. Белогорохов, Е.А. Константинова, А.И. Ефимова, В.Ю. Тимошенко, П.К. Кашкаров 11 1384
- Хвост локализованных состояний в запрещенной зоне квантовой ямы в системе $In_{0.2}Ga_{0.8}N/GaN$ и его влияние на спектр фотолюминесценции при лазерном возбуждении. М.А. Якобсон, Д.К. Нельсон, О.В. Константинов, А.В. Матвеевцев 12 1459
- 5.3.1. Электронные состояния на поверхностях и границах раздела (PACS 73.20)**
- Влияние электрохимической модификации тонкого покровного слоя Ga(In)As на энергетический спектр квантовых точек InAs/GaAs. И.А. Карпович, А.В. Здоровейщев, С.В. Тихов, П.Б. Демина, О.Е. Хапутин 1 45
- Расчет состояний мелких доноров в квантовых ямах в магнитном поле методом разложения по плоским волнам. В.Я. Алешкин, Л.В. Гавриленко 1 63
- Влияние локализации в квантовой яме на время жизни состояний мелких примесных центров. Е.Е. Орлова, P. Harrison, W.-M. Zheng, M.P. Halsall 1 67
- Свойства структур на основе GaAs, легированного Mn из лазерной плазмы в процессе МОС-гидридной эпитаксии. Ю.В. Васильева, Ю.А. Данилов, Ант.А. Ершов, Б.Н. Звонков, Е.А. Ускова, А.Б. Давыдов, Б.А. Аронзон, С.В. Гуденко, В.В. Рьльков, А.Б. Грановский, Е.А. Ганьшина, Н.С. Перов, А.Н. Виноградов 1 87
- Спиновые эффекты в индуцированном параллельном магнитным полем магнитосопротивлении двойной квантовой ямы $n-In_xGa_{1-x}As/GaAs$. М.В. Якунин, Г.А. Альшанский, Ю.Г. Арапов, В.Н. Неверов, Г.И. Харус, Н.Г. Шелушинина, Б.Н. Звонков, Е.А. Ускова, А. де Виссер, Л. Пономаренко 1 118
- Локализация дырок в квантовой молекуле InAs/GaAs. М.М. Соболев, Г.Э. Цырлин, Ю.Б. Самсоненко, Н.К. Поляков, А.А. Тонких, Ю.Г. Мусихин 1 131
- Модель для описания рассеяния дырок на гетерограницах GaAs/AlAs(001). Г.Ф. Караваев, В.Н. Чернышов 3 336

- Тензор проводимости и частота релаксации импульса электронов при рассеянии на ионизированной примеси в магнитном поле: метод матрицы плотности. В.Э. Каминский 5 543
- Локальная туннельная спектроскопия кремниевых наноструктур. Н.Т. Баграев, А.Д. Буравлев, Л.Е. Клячкин, А.М. Маляренко, В. Гельхофф, Ю.И. Романов, С.А. Рыков 6 716
- Свойства структур на основе окисленного пористого кремния при воздействии освещения и газовых сред. Д.И. Биленко, О.Я. Белобровая, Э.А. Жаркова, Д.В. Терин, Е.И. Хасина 7 834
- Characterization of *a*-Si: H/*c*-Si interface by admittance spectroscopy. A.S. Gudovskikh, J.-P. Kleider, E.I. Terukov 8 940
- Влияние субмонослойной металлической пленки на величину изгиба зон полупроводниковой подложки. С.Ю. Давыдов, А.В. Павлык 9 1068
- Поляризация оптического излучения поляронного экситона в анизотропных квантовых точках. А.Ю. Маслов, О.В. Прошина 9 1111
- Стабилизация заряда на границе со скрытым диэлектриком структур кремний-на-изоляторе. И.В. Антонова 10 1195
- Мессбауэровское исследование двухэлектронных донорных центров германия в PbSe. Е.И. Теруков, Э.С. Хужакулов 12 1417
- Оценки энергетических характеристик гетеропереходов 3С-SiC/2H-, 4H-, 6H- и 8H-SiC. С.Ю. Давыдов, А.А. Лебедев, О.В. Посредник 12 1440
- 5.3.2. Барьеры Шоттки (PACS 73.30)**
- Исследование центров рекомбинации, связанных с наноразмерными кластерами As-Sb в низкотемпературном арсениде галлия. П.Н. Брунков, А.А. Гуткин, Ю.Г. Мусихин, В.В. Чалдышев, Н.Н. Берг, С.Г. Конников, В.В. Преображенский, М.А. Пулято, Б.Р. Семягин 1 41
- Термополевой прямой ток в поверхностно-барьерных структурах на основе GaN. Т.В. Бланк, Ю.А. Гольдберг, Е.Е. Заварин, О.В. Константинов, Н.М. Шмидт 6 705
- Особенности переноса заряда в диодах Шоттки на основе полужизолирующего CdTe. Л.А. Косяченко, Е.Л. Масляничук, В.М. Склярчук 6 754
- Водородсодержащие доноры в кремнии — центры с отрицательной эффективной корреляционной энергией. Ю.М. Покотило, А.Н. Петух, В.В. Литвинов, В.Г. Цвырко 7 802
- Влияние субмонослойной металлической пленки на величину изгиба зон полупроводниковой подложки. С.Ю. Давыдов, А.В. Павлык 9 1068
- Формирование потенциальных барьеров в легированных неупорядоченных полупроводниках. Н.В. Вишняков, С.П. Вихров, В.Г. Мишустин, А.П. Авачев, И.Г. Уточкин, А.А. Попов 10 1189
- Моделирование вольт-фарядных характеристик сегнетоэлектрика. Л.С. Берман 12 1436
- Измерения длин диффузии микрометрового диапазона техникой ядерной спектрометрии. Н.Б. Строкан, А.М. Иванов, А.А. Лебедев, М. Syväjärvi, R. Yakimova 12 1443
- 5.3.3. Транспортные явления в структурах, содержащих границы раздела (PACS 73.40)**
- Осцилляции тока при латеральном транспорте в гетероструктурах GaAs/InGaAs с квантовыми ямами. А.В. Антонов, В.И. Гавриленко, Е.В. Демидов, Б.Н. Звонков, Е.А. Ускова 1 53
- Свойства структур на основе GaAs, легированного Mn из лазерной плазмы в процессе МОС-гидридной эпитаксии. Ю.В. Васильева, Ю.А. Данилов, Ант.А. Ершов, Б.Н. Звонков, Е.А. Ускова, А.Б. Давыдов, Б.А. Аронзон, С.В. Гуденко, В.В. Рыльков, А.Б. Грановский, Е.А. Ганьшина, Н.С. Перов, А.Н. Виноградов 1 87
- Изучение свойств структур с нанокластерами Al, внедренными в матрицу GaAs. Н.В. Востоков, С.А. Гусев, В.М. Данильцев, М.Н. Дроздов, Ю.Н. Дроздов, А.И. Корытин, А.В. Мурель, В.И. Шашкин 1 92
- Исследование фотоэлектрических свойств квантовых точек Ge в матрице ZnSe на GaAs. И.Г. Неизвестный, С.П. Супрун, В.Н. Шумский 1 100
- Генератор терагерцевого излучения, основанный на нелинейном преобразовании частоты в двойном вертикальном резонаторе. Ю.А. Морозов, И.С. Нефедов, В.Я. Алешкин, И.В. Красникова 1 124
- Наблюдение излучения среднего инфракрасного диапазона в полупроводниковых лазерах, генерирующих две частотные полосы в ближнем инфракрасном диапазоне. В.Я. Алешкин, В.И. Гавриленко, С.В. Морозов, К.В. Маремьянин, Б.Н. Звонков, С.М. Некоркин 1 153
- Получение и фотоэлектрические свойства гетеропереходов ZnO-Cu(In,Ga)Se₂. В.Ф. Гременок, Г.А. Ильчук, С.Е. Никитин, В.Ю. Рудь, Ю.В. Рудь 2 218
- Качественное различие механизмов процесса электроформовки в структурах Si-SiO₂-W для Si *n*- и *p*-типов проводимости. В.М. Мордвинцев, С.Е. Кудрявцев, В.Л. Левин 2 222
- Неомическая проводимость и механизмы релаксации энергии 2D электронного газа в гетероструктурах GaAs/InGaAs/GaAs. А.А. Шерстобитов, Г.М. Миньков, О.Э. Рут, А.В. Германенко, Б.Н. Звонков 2 237
- Особенности межэлектронного взаимодействия в потенциальной яме сильно легированного гетероперехода Al_xGa_{1-x}As(Si)/GaAs. В.И. Кадушкин 2 242
- Сенсоры аммиака на основе диодов Pd-*n*-Si. В.И. Балюба, В.Ю. Грицык, Т.А. Давыдова, В.М. Калыгина, С.С. Назаров, Л.С. Хлудкова 2 285
- Деполяризация в структуре металл-*p*-сегнетоэлектрик-*n*-полупроводник. Л.С. Берман 3 332
- Модель для описания рассеяния дырок на гетерограницах GaAs/AlAs(001). Г.Ф. Караваев, В.Н. Чернышов 3 336
- Механизмы протекания тока и фоточувствительность структур *n*-ZnO: Al/CuPc/*p*-Cu(In,Ga)Se₂. Г.А. Ильчук, С.Е. Никитин, Ю.А. Николаев, В.Ю. Рудь, Ю.В. Рудь, Е.И. Теруков 3 349
- Фотопреобразование в структурах *n*-ZnO: Al/PdPc/*p*-CuIn₃Se₅. И.В. Боднар, Е.С. Дмитриева, С.Е. Никитин, В.Ю. Рудь, Ю.В. Рудь, Е.И. Теруков 4 426

- Анизотропия эффективной массы Γ -электронов в квантовой яме GaAs/(AlGa)As. Е.Е. Вдовин, Ю.Н. Ханин 4 445
- Резонансные состояния доноров в квантовых ямах. Н.А. Бекин 4 463
- Генерационно-рекомбинационный механизм переноса заряда в тонкопленочном гетеропереходе CdS/CdTe. Л.А. Косяченко, X. Mathew, В.В. Мотушук, В.М. Склярчук 5 569
- Резонансное туннелирование дырок в двубарьерных структурах с квантовыми точками InAs в центре квантовой ямы GaAs. Е.Н. Морозова, О.Н. Макаровский, В.А. Волков, Ю.В. Дубровский, L. Turyanska, Е.Е. Вдовин, A. Patané, L. Eaves, M. Henini 5 573
- Туннельно-рекомбинационные токи и эффективность электролюминесценции InGaN/GaN светодиодов. Н.И. Бочкарева, Е.А. Zhirnov, А.А. Ефремов, Ю.Т. Ребане, Р.И. Горбунов, Ю.Г. Шретер 5 627
- Влияние одноосного сжатия на параметры фотообразования оптического контакта p -GaSe- n -InSe. С.И. Драпак, М.О. Воробец, З.Д. Ковалюк 5 633
- Повышение темпа и дискретизация кинетики изотермической поверхностной генерации неосновных носителей заряда в структурах металл-диэлектрик-полупроводник с планарно-неоднородным диэлектриком. А.Г. Ждан, Е.И. Гольдман, Ю.В. Гуляев, Г.В. Чучева 6 697
- Термополевой прямой ток в поверхностно-барьерных структурах на основе GaN. Т.В. Бланк, Ю.А. Гольдберг, Е.Е. Заварин, О.В. Константинов, Н.М. Шмидт 6 705
- Локальная туннельная спектроскопия кремниевых наноструктур. Н.Т. Баграев, А.Д. Буравлев, Л.Е. Клячкин, А.М. Маляренко, В. Гельхофф, Ю.И. Романов, С.А. Рыков 6 716
- Водородсодержащие доноры в кремнии — центры с отрицательной эффективной корреляционной энергией. Ю.М. Покотило, А.Н. Петух, В.В. Литвинов, В.Г. Цвырко 7 802
- Свойства структур на основе окисленного пористого кремния при воздействии освещения и газовых сред. Д.И. Биленко, О.Я. Белобровая, Э.А. Жаркова, Д.В. Терин, Е.И. Хасина 7 834
- Неомическая прыжковая квазидвумерная проводимость и кинетика ее релаксации. Б.А. Аронзон, Д.Ю. Ковалев, В.В. Рьльков 7 844
- Кулоновское блокирование проводимости пленок SiO_x при одноэлектронной зарядке кремниевой квантовой точки в составе цепочки электронных состояний. М.Д. Ефремов, Г.Н. Камаев, В.А. Володин, С.А. Аржанникова, Г.А. Качурин, С.Г. Черкова, А.В. Крегинин, В.В. Малюткина-Бронская, Д.В. Марин 8 945
- Механизмы токопереноса и свойства гетероструктур α -SiC:H/c-Si. А.А. Шерченков, Б.Г. Будагян, А.В. Мазуров 8 964
- Фотоэлектрические свойства поверхностно-барьерных структур на основе пленок Zn_{2-2x}Cu_xIn₂Se₂, полученных селенизацией. В.Ю. Рудь, Ю.В. Рудь, В.Ф. Гременок, Е.П. Зарецкая, О.Н. Сергеева 9 1070
- Моделирование особенностей эффекта насыщения дрейфовой скорости в субмикронных кремниевых структурах. В.А. Гергель, Ю.В. Гуляев, М.Н. Якупов 9 1075
- Комбинированная модель резонансно-туннельного диода. И.И. Абрамов, И.А. Гончаренко, Н.В. Коломейцева 9 1138
- Спиновое расщепление примесных состояний доноров, связанных с X-долиной в AlAs-барьере, и пространственное распределение плотности вероятности их волновых функций. Е.Е. Вдовин, Ю.Н. Ханин 10 1204
- Исследование свойств двумерного электронного газа в гетероструктурах p^- -3C-SiC/ n^+ -6H-SiC при низких температурах. А.А. Лебедев, Д.К. Нельсон, Б.С. Разбирин, И.И. Сайдашев, А.Н. Кузнецов, А.Е. Черенков 10 1236
- Квазигидродинамическая модификация приближения плавного канала в теории МОП транзистора. В.А. Гергель, М.Н. Якупов 10 1246
- Структурные механизмы оптимизации фотоэлектрических свойств пленочных гетеросистем CdS/CdTe. Г.С. Хрипунов 10 1266
- Чувствительность структур диэлектрик-полупроводник к нестационарным световым потокам. Н.Ф. Ковтонюк, В.П. Мисник, А.В. Соколов 11 1336
- Фоточувствительность гетероструктур на мелкодисперсной фазе полупроводников. Ю.А. Николаев, В.Ю. Рудь, Ю.В. Рудь, Е.И. Теруков, Т.Н. Ушакова 11 1340
- О влиянии поперечного квантования на электрические характеристики туннельной МОП структуры субмикронных размеров. М.И. Векслер, И.В. Грехов, А.Ф. Шулкин 12 1430
- Моделирование вольт-фарадных характеристик сегнетоэлектрика. Л.С. Берман 12 1436
- Измерения длин диффузии микрометрового диапазона техникой ядерной спектрометрии. Н.Б. Строкан, А.М. Иванов, А.А. Лебедев, M. Suväjärv, R. Yakimova 12 1443
- Электрические свойства гетеропереходов n -GaN/ p -SiC. О.Ю. Ледаев, А.М. Стрельчук, А.Н. Кузнецов, Н.В. Середова, А.С. Зубрилов, А.А. Волкова, А.Е. Николаев, А.А. Лебедев 12 1452
- Фоточувствительность гетерофотоэлементов ZnO/CdS/Cu(In,Ga)Se₂ при γ -облучении. В.В. Емцев, Ю.А. Николаев, Д.С. Полоскин, В.Ю. Рудь, Ю.В. Рудь, Е.И. Теруков, М.В. Якушев 12 1455
- 5.3.4. Транспортные явления в тонких пленках (PACS 73.50)**
- Свойства слоев GaSb:Mn, полученных осаждением из лазерной плазмы. Ю.А. Данилов, Е.С. Демидов, Ю.Н. Дроздов, В.П. Лесников, В.В. Подольский 1 8
- Осцилляции тока при латеральном транспорте в гетероструктурах GaAs/InGaAs с квантовыми ямами. А.В. Антонов, В.И. Гавриленко, Е.В. Демидов, Б.Н. Звонков, Е.А. Ускова 1 53
- Гетероструктуры InGaAs/GaAs с квантовыми точками для инфракрасных фотоприемников диапазона 3–5 мкм. А.В. Антонов, Д.М. Гапонова, В.М. Данильцев, М.Н. Дроздов, Л.Д. Молдавская, А.В. Мурель, В.С. Туловчиков, В.И. Шашкин 1 96
- „Необычная“ остаточная фотопроводимость в квантовой яме InAs/AlSb. Ю.Г. Садофьев, A. Ramamoorthy, J.P. Bird, S.R. Johnson, Y.-H. Zhang 1 106

- Латеральная фотопроводимость структур AlGaAs/InGaAs с квантовыми ямами и самоорганизующимися квантовыми точками при межзонной подсветке. О.А. Шегай, А.К. Бакаров, А.К. Калагин, А.И. Торопов 1 115
- Рассеяние носителей заряда на границах кристаллитов в пленках поликристаллического кремния. В.А. Гридчин, В.М. Любимский, А.Г. Моисеев . . . 2 208
- Получение и фотоэлектрические свойства гетеропереходов ZnO–Cu(In,Ga)Se₂. В.Ф. Гременок, Г.А. Ильчук, С.Е. Никитин, В.Ю. Рудь, Ю.В. Рудь . 2 218
- Фотоэлектрические свойства структур n-ZnO:Al/PbPc/p-Si. Г.А. Ильчук, С.Е. Никитин, Ю.А. Николаев, В.Ю. Рудь, Ю.В. Рудь, Е.И. Теруков 2 234
- Получение и фотоэлектрические свойства структур n-ZnO:Al/PdPc/p-Si. Г.А. Ильчук, С.Е. Никитин, Ю.А. Николаев, В.Ю. Рудь, Ю.В. Рудь, Е.И. Теруков 4 433
- Исследование статистики носителей в светодиодных структурах InGaN/GaN. Д.С. Сизов, В.С. Сизов, Е.Е. Заварин, В.В. Лундин, А.В. Фомиин, А.Ф. Цацульников, Н.Н. Леденцов 4 492
- Гетеропереходы p⁺-Si–n-CdF₂. Н.Т. Баграев, Л.Е. Клячкин, А.М. Маляренко, А.И. Рыскин, А.С. Щеулин 5 557
- Электронные и излучательные свойства пористого кремния, легированного золотом. В.Е. Примаченко, Я.Ф. Кононец, Б.М. Булах, Е.Ф. Венгер, Э.Б. Каганович, И.М. Кизяк, С.И. Кириллова, Э.Г. Манойлов, Ю.А. Цыркунов 5 595
- Особенности физических свойств модифицированной поверхности теллурида кадмия. В.П. Махний 7 826
- Обратимые фотоиндуцированные изменения в спектре локализованных состояний в пленках AsSe. Л.П. Казакова, К.Д. Цэндин, М.А. Тагирджанов, Н.С. Аверкиев 8 998
- Ловушки для электронов в тонких слоях низкотемпературного арсенида галлия с наноразмерными кластерами As–Sb. П.Н. Брунков, А.А. Гуткин, В.В. Чалдышев, Н.Н. Берт, С.Г. Конников, В.В. Преображенский, М.А. Путьято, Б.Р. Семягин . 9 1049
- Фотоэлектрические свойства поверхностно-барьерных структур на основе пленок Zn_{2–2x}Cu_xIn_xSe₂, полученных селенизацией. В.Ю. Рудь, Ю.В. Рудь, В.Ф. Гременок, Е.П. Зарецкая, О.Н. Сергеева 9 1070
- Высокочастотный нелинейный отклик двухъямных наноструктур. В.Ф. Елесин, И.Ю. Катеев 9 1106
- Фоточувствительность гетероструктур на мелкодисперсной фазе полупроводников. Ю.А. Николаев, В.Ю. Рудь, Ю.В. Рудь, Е.И. Теруков, Т.Н. Ушакова . 11 1340
- Роль исходного легирования в эффекте изменения концентрации носителей заряда в пористом кремнии при адсорбции молекул аммиака. А.В. Павликов, Л.А. Осминкина, И.А. Белогорохов, Е.А. Константинова, А.И. Ефимова, В.Ю. Тимошенко, П.К. Кашкаров 11 1384
- Фоточувствительность гетерофотоэлементов ZnO/CdS/Cu(In,Ga)Se₂ при γ -облучении. В.В. Емцев, Ю.А. Николаев, Д.С. Полоскин, В.Ю. Рудь, Ю.В. Рудь, Е.И. Теруков, М.В. Якушев 12 1455
- 5.4. Сверхпроводимость (PACS 74). Магнитные свойства (PACS 75), магнитные резонансы (PACS 76)**
- Циклотронный резонанс в легированных и нелегированных гетероструктурах InAs/AlSb с квантовыми ямами. В.Я. Алешкин, В.И. Гавриленко, А.В. Иконников, Ю.Г. Садофьев, J.P. Bird, S.R. Jonhson, Y.-H. Zhang 1 71
- Катионное разупорядочение в двойном оксиде Sr₂FeMoO₆ со структурой перовскита. Л.С. Лобановский, С.В. Труханов, М.В. Бушинский, И.О. Троянчук 3 291
- Исследования медь-углеродных систем методом ЭПР. Б.П. Попов 4 479
- Эффекты магнитного упорядочения в сильно легированных кристаллах GaAs(Fe). Б.П. Попов, В.К. Соболевский, Е.Г. Апушкинский, В.П. Савельев 5 521
- Слабый ферромагнетизм в слоистых кристаллах InSe:Mn. В.В. Слынько, А.Г. Хандожко, З.Д. Ковалюк, А.В. Заслонкин, В.Е. Слынько, М. Arciszewska, W.D. Dobrowolski 7 806
- Магнитные свойства аморфного углерода, модифицированного железом. С.Г. Ястребов, В.И. Иванов-Омский, В. Поп, К. Морошану, А. Слав, Ж. Волрон 7 874
- Спиновой фильтр на квантовом точечном контакте в разбавленном магнитном полупроводнике. С.А. Игнатенко, В.Е. Борисенко 9 1083
- Магнетизм кристаллов A^{III}B^V, легированных редкими землями. Н.Т. Баграев, В.В. Романов 10 1173
- Электронный обмен между нейтральными и ионизированными центрами германия в PbSe. И.Е. Теруков, Э.С. Хужакулов 12 1420
- 5.5. Диэлектрические и пьезоэлектрические свойства (PACS 77)**
- Электрофизические характеристики макросистем диэлектрик–проводник, диэлектрик–полупроводник. В.А. Соцков 2 269
- Деполаризация в структуре металл–p-сегнетоэлектрик–n-полупроводник. Л.С. Берман 3 332
- Моделирование электрических свойств поликристаллических керамических полупроводников с субмикрометровыми размерами зерен. И.В. Рожанский, Д.А. Закгейм 5 608
- Динамический хаос в частично освещенном компенсированном полупроводнике в условиях примесного электрического пробоя. К.М. Джандиери, З.С. Качлишвили, А.Б. Строганов 6 673
- Новый элемент памяти на кремниевых нанокластерах в диэлектрике с высокой диэлектрической проницаемостью ZrO₂ для электрически перепрограммируемого постоянного запоминающего устройства. В.А. Гриценко, К.А. Насыров, Д.В. Гриценко, Ю.Н. Новиков, А.Л. Асеев, Д.Х. Ли, Д.-В. Ли, Ч.В. Ким 6 748
- Сегнетоэлектрический полевой транзистор на основе гетероструктуры Pb(Zr,Ti_{1-x})O₃/SnO₂. И.Е. Титков, И.П. Пронин, Д.В. Машовец, Л.А. Делимова, И.А. Линийчук, И.В. Грехов 7 890
- Моделирование вольт-фарадных характеристик сегнетоэлектрика. Л.С. Берман 12 1436

5.6. Оптические свойства полупроводников, спектроскопия, взаимодействие с различными видами излучений (PACS 78)

- Влияние промежуточного окисного слоя в гетероструктурах металл–квантово-размерный полупроводник In(Ga)As/GaAs на эффективность электролюминесценции. Н.В. Байдусь, П.Б. Демина, М.В. Дорохин, Б.Н. Звонков, Е.И. Мальшева, Е.А. Ускова 1 25
- Спектры остаточной фотопроводимости в гетероструктурах InAs/AlSb с квантовыми ямами. В.Я. Алешкин, В.И. Гавриленко, Д.М. Гапонова, А.В. Иконников, К.В. Маремьянин, С.В. Морозов, Ю.Г. Садофьев, S.R. Johnson, Y.-H. Zhang 1 30
- Долговременная кинетика фотолуминесценции квантовых точек InAs/AlAs в магнитном поле. Т.С. Шамирзаев, А.М. Гилинский, А.К. Бакаров, А.И. Торопов, С.А. Фигуренко, К.С. Журавлев . . . 1 35
- Междозонное поглощение света в гетероструктурах с двойными туннельно-связанными квантовыми ямами GaAs/AlGaAs. Л.Е. Воробьев, В.Ю. Паневин, Н.К. Федосов, Д.А. Фирсов, В.А. Шальгин, В.В. Капаев, S. Hanna, S. Schmidt, E.A. Zibik, A. Seilmeier 1 49
- Оптические явления в гетероструктурах InAs/GaAs с легированными квантовыми точками и искусственными молекулами. Л.Е. Воробьев, В.Ю. Паневин, Н.К. Федосов, Д.А. Фирсов, В.А. Шальгин, A.D. Andreev, Ю.Б. Самсоненко, А.А. Тонких, Г.Э. Цырлин, Н.В. Крыжановская, В.М. Устинов, S. Hanna, A. Seilmeier, N.D. Zakharov, P. Werner . . . 1 59
- Терагерцовая люминесценция гетероструктур на основе GaAs с квантовыми ямами при оптическом возбуждении доноров. Н.А. Бекин, Р.Х. Жукавин, К.А. Ковалевский, С.Г. Павлов, Б.Н. Звонков, Е.А. Ускова, В.Н. Шагин 1 76
- Эффективная фотолуминесценция ближнего инфракрасного диапазона в слоях нитрида галлия, легированного мышьяком. А.В. Андрианов, С.В. Новиков, И.С. Журавлев, Т. Ли, Р. Чаа, С. Булл, И. Харрисон, Е.К. Ларкинс, К.Т. Фоксон 1 82
- Оптические свойства пористого наноразмерного GaAs. А.И. Белогорохов, С.А. Гаврилов, И.А. Белогорохов, А.А. Тихомиров 2 258
- Кинетика и неоднородная инжекция носителей в нанослоях InGaN. Д.С. Сизов, В.С. Сизов, Е.Е. Заварин, В.В. Лундин, А.В. Фомин, А.Ф. Цацульников, Н.Н. Леденцов 2 264
- Спектры отражения двух полиморфных модификаций арсенида кадмия. А.И. Козлов, В.В. Соболев, А.Ф. Князев 3 305
- Экситонная фотолуминесценция и вертикальный транспорт фотовозбужденных носителей в сверхрешетках CdSe/CdMgSe. И.И. Решина, С.В. Иванов, Д.Н. Мирлин, И.В. Седова, С.В. Сорокин 4 456
- Исследование статистики носителей в светодиодных структурах InGaN/GaN. Д.С. Сизов, В.С. Сизов, Е.Е. Заварин, В.В. Лундин, А.В. Фомин, А.Ф. Цацульников, Н.Н. Леденцов 4 492
- Интерфейсная и межзонная лазерная генерация в гетероструктуре InAs/InAsSbP, выращенной методом газофазной эпитаксии из металлорганических соединений. А.П. Астахова, Н.Д. Ильинская, А.Н. Именков, С.С. Кижасев, С.С. Молчанов, Ю.П. Яковлев 4 497
- Влияние р-легирования активной области на температурную стабильность характеристик лазеров на InAs/GaAs-квантовых точках. И.И. Новиков, Н.Ю. Гордеев, Л.Я. Карачинский, М.В. Максимов, Ю.М. Шерняков, А.Р. Ковш, И.Л. Крестников, А.В. Кожухов, С.С. Михрин, Н.Н. Леденцов 4 502
- Температурная зависимость эффективного коэффициента оже-рекомбинации в лазерах InAs/GaAs на квантовых точках с длиной волны излучения 1.3 мкм. И.И. Новиков, Н.Ю. Гордеев, М.В. Максимов, Ю.М. Шерняков, Е.С. Семенова, А.П. Васильев, А.Е. Жуков, В.М. Устинов, Г.Г. Зегря 4 507
- Токи инжекции в узкозонном диэлектрике Pb_{1-x}Sn_xTe(In). А.Н. Акимов, В.Г. Ерков, А.Э. Климов, Е.Л. Молодцова, С.П. Супрун, В.Н. Шумский . . 5 563
- Формирование кремниевых нанокристаллов в слоях SiO₂ при имплантации ионов Si с промежуточными отжигами. Г.А. Качурин, В.А. Володин, Д.И. Тетельбаум, Д.В. Марин, А.Ф. Лейер, А.К. Гутаковский, А.Г. Черков, А.Н. Михайлов . . . 5 582
- Определение концентрации носителей заряда в полукристаллических слоях селенида свинца на основе спектров отражения. А.Е. Гамарц, Ю.М. Канагеева, В.А. Мошников 6 667
- „Модуляция“ характеристик интенсивного пикосекундного стимулированного излучения из GaAs. Н.Н. Агеева, И.Л. Броневова, А.Н. Кривоносос, С.Е. Кумеков, Т.А. Налет, С.В. Стеганцов 6 681
- Спонтанная и стимулированная ультрафиолетовая люминесценция ZnO:N при температуре 77 К. А.Н. Георгоблани, А.Н. Грузинцев, Е.Е. Якимов, С. Barthou, P. Benalloul 6 692
- Электроотражение и отражение структуры GaAs/AlGaAs с одиночной квантовой ямой при комнатной температуре. А.А. Герасимович, С.В. Жоховец, Г. Гобш, Д.С. Доманевский 6 729
- Оптические свойства гетероструктур с квантово-размерными слоями InGaAsN на подложках GaAs, излучающих в области 1.3–1.55 мкм. Н.В. Крыжановская, А.Ю. Егоров, В.В. Мамутин, Н.К. Поляков, А.Ф. Цацульников, А.Р. Ковш, Н.Н. Леденцов, В.М. Устинов, Д. Бимберг 6 735
- Интерпретация видимой фотолуминесценции взвешенных в этаноле разновеликих наночастиц кремния. В.Е. Оглуздин 8 920
- Спектры диэлектрической проницаемости и характеристических потерь электронов оксида цинка при 100 К. В.Вал. Соболев, В.В. Соболев, Е.И. Теруков . 8 935
- Структурные преобразования и оптические свойства халькогенидных стекол As₂S₃. И.В. Фекашгази, К.В. Май, Н.И. Мателешко, В.М. Мица, Е.И. Боркач . 8 986
- Влияние увеличения дозы имплантации ионов эрбия и температуры отжига на фотолуминесценцию в сверхрешетках AlGaIn/GaN и эпитаксиальных слоях GaN. А.М. Емельянов, Н.А. Соболев, Е.И. Шек, В.В. Лундин, А.С. Усиков, Е.О. Паршин . 9 1080

- Поляризация оптического излучения полярного экситона в анизотропных квантовых точках. А.Ю. Маслов, О.В. Прошина 9 1111
- Излучательная рекомбинация нанокристаллов GaN при большой мощности оптического возбуждения. А.Н. Грузинцев, А.Н. Редькин, С. Barthou 10 1200
- Влияние квантово-размерного эффекта на оптические свойства нанокристаллов Ge в пленках GeO₂. Е.Б. Горохов, В.А. Володин, Д.В. Марин, Д.А. Орехов, А.Г. Черков, А.К. Гутаковский, В.А. Швец, А.Г. Борисов, М.Д. Ефремов 10 1210
- Неравновесный характер распределения носителей при комнатной температуре в квантовых точках InAs, покрытых тонкими слоями AlAs/InAlAs. Н.В. Крыжановская, А.Г. Гладышев, С.А. Блохин, М.В. Максимов, Е.С. Семенова, А.П. Васильев, А.Е. Жуков, Н.Н. Леденцов, В.М. Устинов, Д. Бимберг 10 1230
- Кинетика фазово-структурных преобразований в тонких пленках SiO_x в процессе быстрого термического отжига. В.А. Данько, И.З. Индутный, В.С. Лысенко, И.Ю. Майданчук, В.И. Минько, А.Н. Назаров, А.С. Ткаченко, П.Е. Шепелявый 10 1239
- Исследование электронного спектра структур с квантовыми точками InGaN с помощью спектроскопии фототока. Д.С. Сизов, В.С. Сизов, В.В. Лундин, А.Ф. Цацульников, Е.Е. Заварин, Н.Н. Леденцов . . 11 1350
- Особенности фотолюминесценции структур InAs/GaAs с квантовыми точками при различной мощности накачки. В.А. Кульбачинский, В.А. Rogozin, Р.А. Лунин, А.А. Белов, А.Л. Карузский, А.В. Пересторонин, А.В. Здоровейцев 11 1354
- Межзонное поглощение света в размерно-ограниченных системах в однородном электрическом поле. Э.П. Синявский, С.М. Соковнич, Р.А. Хамидуллин . 11 1359
- Фотолюминесценция кремниевых нанокристаллов под действием электрического поля. Е.Н. Вандышев, А.М. Гишинский, Т.С. Шамирзаев, К.С. Журавлев . 11 1365
- Циркулярная поляризация люминесценции, обусловленная током в квантовых ямах. Н.С. Аверкиев, А.Ю. Силов 11 1370
- Наноконпозиты опал-ZnO: структура и эмиссионные свойства. Г.А. Емельченко, А.Н. Грузинцев, М.Н. Ковальчук, В.М. Маслов, Э.Н. Самаров, Е.Е. Якимов, С. Barthou, И.И. Зверькова 11 1374
- Усиление интенсивности спонтанного излучения эрбия вблизи края фотонной зоны распределенных брэгговских отражателей на основе a-Si:H/a-SiO_x:H. А.В. Медведев, Н.А. Феоктистов, А.Б. Певцов, В.Г. Голубев 11 1402
- Хвост локализованных состояний в запрещенной зоне квантовой ямы в системе In_{0.2}Ga_{0.8}N/GaN и его влияние на спектр фотолюминесценции при лазерном возбуждении. М.А. Якобсон, Д.К. Нельсон, О.В. Константинов, А.В. Матвеев 12 1459
- Непрерывный режим генерации одноименных метаморфных лазеров на квантовых точках спектрального диапазона 1.5 мкм. Л.Я. Карачинский, Т. Kettler, Н.Ю. Гордеев, И.И. Новиков, М.В. Максимов, Ю.М. Шерняков, Н.В. Крыжановская, А.Е. Жуков, Е.С. Семенова, А.П. Васильев, В.М. Устинов, Н.Н. Леденцов, А.Р. Ковш, В.А. Щукин, С.С. Михрин, А. Lochmann, O. Schulz, L. Reissmann, D. Bimberg 12 1464
- 5.6.1. Оптические свойства объемных материалов (PACS 78.20)**
- Спектры отражения двух полиморфных модификаций арсенида кадмия. А.И. Козлов, В.В. Соболев, А.Ф. Князев 3 305
- Spectroscopic parameters of LVM absorption bands of carbon and oxygen impurities in isotopic enriched silicon ²⁸Si, ²⁹Si and ³⁰Si. P.G. Sennikov, T.V. Kotereva, A.G. Kurganov, B.A. Andreev, H. Niemann, D. Schiel, V.V. Emtsev, H.-J. Pohl 3 320
- Оптическое поглощение и диффузия хрома в монокристаллах ZnSe. Ю.Ф. Вакман, В.В. Павлов, Ю.А. Нищук, Ю.Н. Пуртов, А.С. Насибов, П.В. Шапкин 4 401
- Электроотражение и отражение структуры GaAs/AlGaAs с одиночной квантовой ямой при комнатной температуре. А.А. Герасимович, С.В. Жоховец, Г. Гобш, Д.С. Доманевский 6 729
- Исследование ориентации молекул жидкого кристалла E7 в композитах на основе щелевого кремния поляризационными методами инфракрасной спектроскопии и комбинационного рассеяния света. Е.В. Астрова, Т.С. Перова, С.А. Грудинкин, В.А. Толмачев, Ю.А. Пилгогина, В.Б. Воронков, J.K. Vij 7 793
- Дисперсия показателя преломления в кристаллах Tl_{1-x}Cu_xGaSe₂ (0 ≤ x ≤ 0.02) и Tl_{1-x}Cu_xInS₂ (0 ≤ x ≤ 0.015). А.Н. Георгобиани, А.Х. Матиев, Б.М. Хамхоев 7 811
- Анизотропия показателя преломления и электрооптический эффект в кристаллах Tl_{1-x}Cu_xGaSe₂ (0 ≤ x ≤ 0.02). А.Н. Георгобиани, А.Х. Матиев, Б.М. Хамхоев 7 820
- Спектры диэлектрической проницаемости и характеристических потерь электронов оксида цинка при 100 К. В.Вал. Соболев, В.В. Соболев, Е.И. Теруков . 8 935
- Оптические свойства кристаллов ZnGeP₂ в ультрафиолетовой области. Ю.М. Басалаев, А.Б. Гордиенко, А.С. Поплавной 9 1040
- Исследование свойств Hg_{1-x-y-z}Cd_xMn_yZn_zTe как нового материала оптоэлектроники для инфракрасного диапазона. И.Н. Горбатюк, С.Э. Остапов, С.Г. Дремлюженко, Р.А. Заплитный, И.М. Фодчук, В.В. Жихаревич, В.Г. Дейбук, Н.А. Попенко, И.В. Иванченко, А.А. Жигалов, С.Ю. Карелин . . . 9 1053
- Особенности физического дифференцирования по коэффициенту поглощения света в спектрах вентильной фотоэде. Л.И. Бережинский, Е.Ф. Венгер, И.Е. Матяш, А.В. Саченко, Б.К. Сердега 10 1164
- Магнетизм кристаллов A^{III}B^V, легированных редкими землями. Н.Т. Баграев, В.В. Романов 10 1173
- 5.6.2. Инфракрасная спектроскопия, комбинационное рассеяние (PACS 78.30)**
- Резонансное комбинационное рассеяние света и атомно-силовая микроскопия многослойных наноструктур InGaAs/GaAs с квантовыми точками. М.Я. Валах, В.В. Стрельчук, А.Ф. Коломыс, Yu.I. Mazur, Z.M. Wang, M. Xiao, G.J. Salamo 1 140
- Фотолюминесценция и комбинационное рассеяние света в пористом GaSb, сформированном ионной имплантацией. Ю.А. Данилов, А.А. Бирюков, J.L. Gonçaves, J.W. Swart, F. Iikawa, O. Teschke . . . 1 145

- Спектры комбинационного рассеяния света монокристаллов GaSe, подвергнутых воздействию лазерного облучения. А. Байдуллаева, З.К. Власенко, Б.К. Даулетмуратов, Л.Ф. Кузан, П.Е. Мозоль 4 405
- Электрофизические и оптические свойства InP, облученного большими интегральными потоками нейтронов. В.Н. Брудный, Н.Г. Колин, Д.И. Меркурисов, В.А. Новиков 5 528
- Формирование кремниевых нанокристаллов в слоях SiO₂ при имплантации ионов Si с промежуточными отжигами. Г.А. Качурин, В.А. Володин, Д.И. Тетельбаум, Д.В. Марин, А.Ф. Лейер, А.К. Гутаковский, А.Г. Черков, А.Н. Михайлов . . . 5 582
- Влияние температуры вакуумного отжига на край фундаментального поглощения и структурную релаксацию пленок α-SiC:Н. А.В. Васин, А.В. Русавский, В.С. Лысенко, А.Н. Назаров, В.И. Кушниренко, С.П. Старик, В.Г. Степанов 5 602
- Особенности колебательных спектров алмазоподобных и полимероподобных пленок α-C:Н. Е.А. Коншина, А.И. Вангонен 5 616
- Определение концентрации носителей заряда в полукристаллических слоях селенида свинца на основе спектров отражения. А.Е. Гамарц, Ю.М. Канегеева, В.А. Мошников 6 667
- Физические свойства CdTe при совместном легировании V и Ge. С.Ю. Паранчич, Л.Д. Паранчич, В.Н. Макогоненко, Ю.В. Танасюк, М.Д. Андрийчук, В.Р. Романюк 6 744
- Исследование ориентации молекул жидкого кристалла E7 в композитах на основе щелевого кремния поляризационными методами инфракрасной спектроскопии и комбинационного рассеяния света. Е.В. Астрова, Т.С. Перова, С.А. Грудинкин, В.А. Толмачев, Ю.А. Пилюгина, В.Б. Воронков, J.K. Vij 7 793
- Транспорт протонов в аморфном гидрогенизированном углеороде. В.И. Иванов-Омский, С.Г. Ястребов . 8 976
- Структурные преобразования и оптические свойства халькогенидных стекол As₂S₃. И.В. Фекешгази, К.В. Май, Н.И. Мателешко, В.М. Мица, Е.И. Боркач 8 986
- Взаимодействие фуллерена с монокристаллическим кремнием. О.М. Сресели, И.Б. Захарова, С.П. Вуль, Т.Л. Макарова, Л.В. Шаронова, Л.В. Беляков, Д.Н. Горячев 8 1017
- 5.6.3. Люминесценция, излучательная рекомбинация (PACS 78.55; 78.60)**
- Получение слоев VGaAs методом МОГФЭ на подложках GaAs. Д.А. Пряхин, В.М. Данильцев, Ю.Н. Дроздов, М.Н. Дроздов, Д.М. Гапонова, А.В. Мурель, В.И. Шашкин, S. Rushworth 1 17
- Особенности эпитаксиального наращивания GaN при пониженном давлении в реакторе МОГФЭ. О.И. Хрыкин, А.В. Бутин, Д.М. Гапонова, В.М. Данильцев, М.Н. Дроздов, Ю.Н. Дроздов, А.В. Мурель, В.И. Шашкин 1 21
- Влияние промежуточного окисного слоя в гетероструктурах металл-квантово-размерный полупроводник In(Ga)As/GaAs на эффективность электролюминесценции. Н.В. Байдусь, П.Б. Демина, М.В. Дорохин, Б.Н. Звонков, Е.И. Малышева, Е.А. Ускова 1 25
- Долговременная кинетика фотолюминесценции квантовых точек InAs/AlAs в магнитном поле. Т.С. Шамирзаев, А.М. Гилинский, А.К. Бакаров, А.И. Торопов, С.А. Фигуренко, К.С. Журавлев . . . 1 35
- Электролюминесцентные свойства гетероструктур с квантовыми ямами GaInNAs. А.В. Мурель, В.М. Данильцев, Ю.Н. Дроздов, Д.М. Гапонова, В.И. Шашкин, В.Б. Шмагин, О.И. Хрыкин 1 38
- Оптические явления в гетероструктурах InAs/GaAs с легированными квантовыми точками и искусственными молекулами. Л.Е. Воробьев, В.Ю. Паневин, Н.К. Федосов, Д.А. Фирсов, В.А. Шалыгин, А.Д. Andreev, Ю.Б. Самсоненко, А.А. Тонких, Г.Э. Цырлин, Н.В. Крыжановская, В.М. Устинов, S. Hanna, A. Seilmeier, N.D. Zakharov, P. Werner . . . 1 59
- Эффективная фотолюминесценция ближнего инфракрасного диапазона в слоях нитрида галлия, легированного мышьяком. А.В. Андрианов, С.В. Новиков, И.С. Журавлев, Т. Ли, Р. Чаа, С. Булл, И. Харрисон, Е.К. Ларкинс, К.Т. Фоксон 1 82
- Исследование способов получения и свойств квантовых молекул InAs в матрице GaAs. Ю.Б. Самсоненко, Г.Э. Цырлин, А.А. Тонких, Н.К. Поляков, Н.В. Крыжановская, В.М. Устинов, Л.Е. Воробьев, Д.А. Фирсов, В.А. Шалыгин, N.D. Zakharov, P. Werner, A. Andreev 1 136
- Резонансное комбинационное рассеяние света и атомно-силовая микроскопия многослойных наноструктур InGaAs/GaAs с квантовыми точками. М.Я. Валах, В.В. Стрельчук, А.Ф. Коломыс, Yu.I. Mazur, Z.M. Wang, M. Xiao, G.J. Salamo 1 140
- Фотолюминесценция и комбинационное рассеяние света в пористом GaSb, сформированном ионной имплантацией. Ю.А. Данилов, А.А. Бирюков, J.L. Gonçalves, J.W. Swart, F. Iikawa, O. Teschke . . . 1 145
- Эффективность лавинных светодиодов на основе пористого кремния. С.К. Лазарук, А.А. Лешок, В.А. Лабунов, В.Е. Борисенко 1 149
- Люминесценция λ = 6–9 мкм многослойных структур на основе InAsSb. Н.В. Зотова, С.А. Карандашев, Б.А. Матвеев, М.А. Ременный, Н.М. Стусь, Н.Г. Тараканова 2 230
- Влияние уплотнения на люминесцентные свойства порошков ZnS:Ga. Ю.Ю. Бачериков, Н.В. Кицюк, С.В. Оптасюк, А.А. Стадник 3 316
- Краевая фотолюминесценция при комнатной температуре монокристаллического кремния. Е.Г. Гуле, Э.Б. Каганович, И.М. Кизяк, Э.Г. Манойлов, С.В. Свечников 4 430
- Влияние кислорода на электронную зонную структуру ZnS. Н.К. Морозова, И.А. Каретников, К.В. Голуб, Н.Д. Данилевич, В.М. Лисицын, В.И. Олешко 5 513
- Электронные и излучательные свойства пористого кремния, легированного золотом. В.Е. Примаченко, Я.Ф. Кононец, Б.М. Булах, Е.Ф. Венгер, Э.Б. Каганович, И.М. Кизяк, С.И. Кириллова, Э.Г. Манойлов, Ю.А. Цыркунов 5 595
- Влияние температуры вакуумного отжига на край фундаментального поглощения и структурную релаксацию пленок α-SiC:Н. А.В. Васин, А.В. Русавский, В.С. Лысенко, А.Н. Назаров, В.И. Кушниренко, С.П. Старик, В.Г. Степанов 5 602

- Спонтанная и стимулированная ультрафиолетовая люминесценция ZnO:N при температуре 77 К. А.Н. Георгобиани, А.Н. Грузинцев, Е.Е. Якимов, С. Barthou, P. Benalloul 6 692
- Низкотемпературные нестабильности электрических свойств полужолирующих кристаллов $\text{Cd}_{0.96}\text{Zn}_{0.04}\text{Te}:\text{Cl}$. А.В. Савицкий, О.А. Парфенюк, М.И. Илащук, К.С. Уляницкий, С.Н. Чупыра, Н.Д. Вахняк 7 788
- Особенности физических свойств модифицированной поверхности теллурида кадмия. В.П. Махний 7 826
- Влияние состояний на границах раздела на емкость и эффективность электролюминесценции InGaN/GaN-светодиодов. Н.И. Бочкарева, Е.А. Жирнов, А.А. Ефремов, Ю.Т. Ребане, Р.И. Горбунов, А.В. Клочков, Д.А. Лавринович, Ю.Г. Шретер 7 829
- Интерпретация видимой фотолюминесценции взвешенных в этаноле разновеликих наночастиц кремния. В.Е. Оглуздин 8 920
- Фотолюминесценция легированных эрбием алюмооксидных пленок со встроенными кремниевыми наночастицами. С.К. Лазарук, А.В. Мудрый, А.В. Иванюкович, А.А. Лешок, Д.Н. Унучек, В.А. Лабунов 8 927
- Влияние эрбия и кислорода на интенсивность фотолюминесценции эрбия и состав пленок $\alpha\text{-SiO}_2:\text{H}(\text{Er},\text{O})$, полученных магнетронным распылением на постоянном токе. Ю.К. Ундалов, Е.И. Теруков, О.Б. Гусев, В.Х. Кудоярова 8 979
- Бозонный пик в спектрах комбинационного рассеяния стекол $\text{As}_x\text{S}_{1-x}$. Д. Арсова, Я. Булметис, К. Раптис, В. Памукчисва, Е. Скордева 8 995
- Взаимодействие фуллерепа с монокристаллическим кремнием. О.М. Сресели, И.Б. Захарова, С.П. Вуль, Т.Л. Макарова, Л.В. Шаронова, Л.В. Беляков, Д.Н. Горячев 8 1017
- Микрофотолюминесценция нелегированного монокристаллического теллурида цинка, полученного неравновесными парофазными методами. В.В. Ушаков, Ю.В. Клевков 9 1029
- Точная самокомпенсация проводимости в кристалле $\text{Cd}_{0.95}\text{Zn}_{0.05}\text{Te}:\text{Cl}$ в широком интервале давлений пара Cd. О.А. Матвеев, А.И. Терентьев, Н.К. Зеленина, В.Н. Гуськов, В.Е. Седов, А.А. Томасов, В.П. Карпенко 9 1034
- Влияние увеличения дозы имплантации ионов эрбия и температуры отжига на фотолюминесценцию в сверхрешетках AlGaIn/GaN и эпитаксиальных слоях GaN. А.М. Емельянов, Н.А. Соболев, Е.И. Шек, В.В. Лундин, А.С. Усиков, Е.О. Паршин 9 1080
- О механизме электролюминесценции в кремниевых диодах с большой концентрацией дислокаций. А.В. Саченко, Ю.В. Крюченко 9 1132
- Механизм излучательной рекомбинации в твердых растворах Si-Ge в области межзонных переходов. А.М. Емельянов, Н.А. Соболев, Т.М. Мельникова, Н.В. Абросимов 10 1170
- Исследование некоторых свойств структур Si-Si_{1-x}Ge_x (0 ≤ x ≤ 1), выращенных из ограниченного оловянного раствора-расплава методом жидкофазной эпитаксии. Б. Сапаев, А.С. Саидов 10 1183
- Излучательная рекомбинация нанокристаллов GaN при большой мощности оптического возбуждения. А.Н. Грузинцев, А.Н. Редькин, С. Barthou 10 1200
- Терагерцовая электролюминесценция за счет пространственно не прямых межподзонных переходов в квантово-каскадной структуре GaAs/AlGaAs. Г.Ф. Глинский, А.В. Андрианов, О.М. Сресели, Н.Н. Зиновьев 10 1224
- Электролюминесцентные свойства светодиодов на основе p-Si, подвергнутых деформации. Н.А. Соболев, А.М. Емельянов, Е.И. Шек, О.В. Феклисова, Е.Б. Якимов 10 1271
- Особенности фотолюминесценции структур InAs/GaAs с квантовыми точками при различной мощности накачки. В.А. Кульбачинский, В.А. Рогозин, Р.А. Лунин, А.А. Белов, А.Л. Карузский, А.В. Пересторонин, А.В. Здоровейцев 11 1354
- Фотолюминесценция кремниевых нанокристаллов под действием электрического поля. Е.Н. Вандышев, А.М. Гишинский, Т.С. Шамирзаев, К.С. Журавлев 11 1365
- Циркулярная поляризация люминесценции, обусловленная током в квантовых ямах. Н.С. Аверкиев, А.Ю. Силов 11 1370
- Наноконпозиты опал-ZnO: структура и эмиссионные свойства. Г.А. Емельченко, А.Н. Грузинцев, М.Н. Ковальчук, В.М. Маслов, Э.Н. Самаров, Е.Е. Якимов, С. Barthou, И.И. Зверькова 11 1374
- Люминесценция и электропроводность полиамидокислоты и ее металл-полимерных комплексов с La и Tb. Э.А. Лебедев, М.Я. Гойхман, Д.М. Жигунов, И.В. Подешво, В.В. Кудрявцев, В.Ю. Тимошенко 11 1379
- Электролюминесценция варизонных структур с антизапорным и омическим контактами. Б.С. Соколовский, В.И. Иванов-Омский, Г.А. Ильчук 12 1409
- Светоизлучающие структуры Si:Er, полученные методом молекулярно-лучевой эпитаксии: фотолюминесцентная спектроскопия высокого разрешения. Д.И. Крыжков, Н.А. Соболев, Б.А. Андреев, Д.В. Денисов, З.Ф. Красильник, Е.И. Шек 12 1448
- Хвост локализованных состояний в запрещенной зоне квантовой ямы в системе In_{0.2}Ga_{0.8}N/GaN и его влияние на спектр фотолюминесценции при лазерном возбуждении. М.А. Якобсон, Д.К. Нельсон, О.В. Константинов, А.В. Матвеевцев 12 1459
- 5.6.4. Оптические свойства тонких пленок, поверхностей и структур, содержащих границы раздела (сверхрешетки, гетеропереходы и т. п.) (PACS 78.66)**
- Эффективная фотолюминесценция ближнего инфракрасного диапазона в слоях нитрида галлия, легированного мышьяком. А.В. Андрианов, С.В. Новиков, И.С. Журавлев, Т. Ли, Р. Чаа, С. Булл, И. Харрисон, Е.К. Ларкинс, К.Т. Фоксон 1 82
- Фотоэлектрические свойства структур n-ZnO:Al/PbPc/p-Si. Г.А. Ильчук, С.Е. Никитин, Ю.А. Николаев, В.Ю. Рудь, Ю.В. Рудь, Е.И. Теруков 2 234
- Особенности электропроводности легированных пленок $\alpha\text{-Si}:\text{H}$ с нанокристаллами кремния. С.А. Аржанникова, М.Д. Ефремов, Г.Н. Камаев, А.В. Вишняков, В.А. Володин 4 472

Влияние температуры вакуумного отжига на край фундаментального поглощения и структурную релаксацию пленок α -SiC:Н. А.В. Васин, А.В. Русавский, В.С. Лысенко, А.Н. Назаров, В.И. Кушниренко, С.П. Старик, В.Г. Степанов	5	602
Влияние одноосного сжатия на параметры фотообразования оптического контакта p -GaSe- n -InSe. С.И. Драпак, М.О. Воробец, З.Д. Ковалюк	5	633
Определение концентрации носителей заряда в полукристаллических слоях селенида свинца на основе спектров отражения. А.Е. Гамарц, Ю.М. Канагеева, В.А. Мошников	6	667
Дисперсия показателя преломления в кристаллах $Tl_{1-x}Cu_xGaSe_2$ ($0 \leq x \leq 0.02$) и $Tl_{1-x}Cu_xInS_2$ ($0 \leq x \leq 0.015$). А.Н. Георгобиани, А.Х. Матиев, Б.М. Хамхоев	7	811
Анизотропия показателя преломления и электрооптический эффект в кристаллах $Tl_{1-x}Cu_xGaSe_2$ ($0 \leq x \leq 0.02$). А.Н. Георгобиани, А.Х. Матиев, Б.М. Хамхоев	7	820
Фотолюминесценция легированных эрбием алюмооксидных пленок со встроенными кремниевыми наночастицами. С.К. Лазарук, А.В. Мудрый, А.В. Иванюкович, А.А. Лешок, Д.Н. Унучек, В.А. Лабунов	8	927
Исследование углеродной структуры композитных пленок a -C:H(Cu) и a -C:H(Co) методом рамановской спектроскопии. Э.А. Сморгонская, В.И. Иванов-Омский	8	970
Свойства аморфных пленок халькогенидов мышьяка, модифицированных комплексными соединениями редкоземельных элементов. С.А. Козюхин, А.Р. Файрушин, Э.Н. Воронков	8	1012
Взаимодействие фуллерена с монокристаллическим кремнием. О.М. Сресели, И.Б. Захарова, С.П. Вуль, Т.Л. Макарова, Л.В. Шаронова, Л.В. Беляков, Д.Н. Горячев	8	1017
Влияние увеличения дозы имплантации ионов эрбия и температуры отжига на фотолюминесценцию в сверхрешетках AlGaIn/GaN и эпитаксиальных слоях GaN. А.М. Емельянов, Н.А. Соболев, Е.И. Шек, В.В. Лундин, А.С. Усиков, Е.О. Паршин	9	1080
Исследование свойств двумерного электронного газа в гетероструктурах p^- -3C-SiC/ n^+ -6H-SiC при низких температурах. А.А. Лебедев, Д.К. Нельсон, Б.С. Разбирин, И.И. Сайдашев, А.Н. Кузнецов, А.Е. Черенков	10	1236
Нанокompозиты опал-ZnO: структура и эмиссионные свойства. Г.А. Емельченко, А.Н. Грузинцев, М.Н. Ковальчук, В.М. Маслов, Э.Н. Самаров, Е.Е. Якимов, С. Varthou, И.И. Зверькова	11	1374
Люминесценция и электропроводность полиамидокислоты и ее металл-полимерных комплексов с La и Tb. Э.А. Лебедев, М.Я. Гойхман, Д.М. Жигунов, И.В. Подешво, В.В. Кудрявцев, В.Ю. Тимошенко	11	1379
5.7. Эмиссия электронов и ионов. Ударная ионизация (PACS 79)		
„Модуляция“ характеристик интенсивного пикосекундного стимулированного излучения из GaAs. Н.Н. Агеева, И.Л. Броневой, А.Н. Кривоносков, С.Е. Кумеков, Т.А. Налет, С.В. Стеганцов	6	681

6. Технология, материаловедение, применение полупроводников (PACS 80)

О природе температурного гистерезиса эффективного модуля сдвига в монокристаллическом кремнии. А.В. Олейнич-Лысюк, Б.И. Гуцуляк, И.М. Фодчук	7	769
6.1. Методы получения и обработки полупроводниковых материалов (PACS 81; 82)		
Влияние параметров сапфировых подложек на кристаллическое качество слоев GaN. Ю.Н. Дроздов, Н.В. Востоков, Д.М. Гапонова, В.М. Данильцев, М.Н. Дроздов, О.И. Хрыкин, А.С. Филимонов, В.И. Шашкин	1	5
Свойства слоев GaSb:Mn, полученных осаждением из лазерной плазмы. Ю.А. Данилов, Е.С. Демидов, Ю.Н. Дроздов, В.П. Лесников, В.В. Подольский	1	8
Влияние параметров процесса МОГФЭ на свойства эпитаксиальных пленок GaInAsN. В.М. Данильцев, Д.М. Гапонова, М.Н. Дроздов, Ю.Н. Дроздов, А.В. Мурель, Д.А. Пряхин, О.И. Хрыкин, В.И. Шашкин	1	13
Влияние промежуточного окисного слоя в гетероструктурах металл-квантово-размерный полупроводник In(Ga)As/GaAs на эффективность электролюминесценции. Н.В. Байдусь, П.Б. Демина, М.В. Дорохин, Б.Н. Звонков, Е.И. Малышева, Е.А. Ускова	1	25
Электролюминесцентные свойства гетероструктур с квантовыми ямами GaInNAs. А.В. Мурель, В.М. Данильцев, Ю.Н. Дроздов, Д.М. Гапонова, В.И. Шашкин, В.Б. Шмагин, О.И. Хрыкин	1	38
Влияние электрохимической модификации тонкого покровного слоя Ga(In)As на энергетический спектр квантовых точек InAs/GaAs. И.А. Карпович, А.В. Здоровейцев, С.В. Тихов, П.Б. Демина, О.Е. Хапугин	1	45
Изучение свойств структур с нанокластерами Al, внедренными в матрицу GaAs. Н.В. Востоков, С.А. Гусев, В.М. Данильцев, М.Н. Дроздов, Ю.Н. Дроздов, А.И. Кoryтин, А.В. Мурель, В.И. Шашкин	1	92
Гетероструктуры InGaAs/GaAs с квантовыми точками для инфракрасных фотоприемников диапазона 3–5 мкм. А.В. Антонов, Д.М. Гапонова, В.М. Данильцев, М.Н. Дроздов, Л.Д. Молдавская, А.В. Мурель, В.С. Туловчиков, В.И. Шашкин	1	96
Латеральная фотопроводимость структур AlGaAs/InGaAs с квантовыми ямами и самоорганизующимися квантовыми точками при межзонной подсветке. О.А. Шегай, А.К. Бакаров, А.К. Калагин, А.И. Торопов	1	115
Исследование способов получения и свойств квантовых молекул InAs в матрице GaAs. Ю.Б. Самсоненко, Г.Э. Цырлин, А.А. Тонких, Н.К. Поляков, Н.В. Крыжановская, В.М. Устинов, Л.Е. Воробьев, Д.А. Фирсов, В.А. Шалыгин, N.D. Zakharov, P. Werner, A. Andreev	1	136

- Резонансное комбинационное рассеяние света и атомно-силовая микроскопия многослойных наноструктур InGaAs/GaAs с квантовыми точками. М.Я. Валах, В.В. Стрельчук, А.Ф. Коломыс, Yu.I. Mazur, Z.M. Wang, M. Xiao, G.J. Salamo 1 140
- Влияние импульсного токового отжига на электрофизические характеристики поликристаллического кремния *p*-типа. В.А. Гридчин, В.М. Любимский . . 2 192
- Влияние лазерного излучения на формирование ориентированных слоев сульфида кадмия в резко неравновесных условиях. А.П. Беляев, В.П. Рубец, В.В. Антипов 2 204
- Качественное различие механизмов процесса электроформовки в структурах Si-SiO₂-W для Si *n*- и *p*-типов проводимости. В.М. Мордвинцев, С.Е. Кудрявцев, В.Л. Левин 2 222
- Сенсоры аммиака на основе диодов Pd-*n*-Si. В.И. Балюба, В.Ю. Грицык, Т.А. Давыдова, В.М. Калыгина, С.С. Назаров, Л.С. Хлудкова 2 285
- Вакансионная модель процесса гетерополистной эпитаксии SiC. А.А. Лебедев, С.Ю. Давыдов 3 296
- Внутреннее трение в полупроводниковых тонких пленках, полученных методом золь-гель технологии. А.С. Ильин, А.И. Максимов, В.А. Мошников, Н.П. Ярославцев 3 300
- Спектры отражения двух полиморфных модификаций арсенида кадмия. А.И. Козлов, В.В. Соболев, А.Ф. Князев 3 305
- Atmospheric adsorption effects in hot wire chemical vapour deposition microcrystalline silicon films with different electrode configurations. S.K. Persheyev, V. Smirnov, K.A. O'Neill, S. Reynolds, M.J. Rose . . . 3 361
- Роль примеси бора в активации свободных носителей заряда в слоях пористого кремния при адсорбции акцепторных молекул. Л.А. Осминкина, Е.А. Константинова, К.С. Шаров, П.К. Кашкаров, В.Ю. Тимошенко 3 365
- Оптическое поглощение и диффузия хрома в монокристаллах ZnSe. Ю.Ф. Вакман, В.В. Павлов, Ю.А. Ницук, Ю.Н. Пуртов, А.С. Насибов, П.В. Шапкин 4 401
- Фотопреобразование в структурах *n*-ZnO:Al/PdPc/*p*-CuIn₃Se₅. И.В. Боднар, Е.С. Дмитриева, С.Е. Никитин, В.Ю. Рудь, Ю.В. Рудь, Е.И. Теруков . 4 426
- Получение и фотоэлектрические свойства структуры *n*-ZnO:Al/PdPc/*p*-Si. Г.А. Ильчук, С.Е. Никитин, Ю.А. Николаев, В.Ю. Рудь, Ю.В. Рудь, Е.И. Теруков 4 433
- Влияние адсорбции молекул пиридина на концентрацию свободных носителей заряда и спиновых центров в слоях пористого кремния. Л.А. Осминкина, А.С. Воронцов, Е.А. Константинова, В.Ю. Тимошенко, П.К. Кашкаров 4 482
- Влияние *p*-легирования активной области на температурную стабильность характеристик лазеров на InAs/GaAs-квантовых точках. И.И. Новиков, Н.Ю. Гордеев, Л.Я. Карачинский, М.В. Максимов, Ю.М. Шерняков, А.Р. Ковш, И.Л. Крестников, А.В. Кожухов, С.С. Михрин, Н.Н. Леденцов 4 502
- Температурная зависимость эффективного коэффициента оже-рекомбинации в лазерах InAs/GaAs на квантовых точках с длиной волны излучения 1.3 мкм. И.И. Новиков, Н.Ю. Гордеев, М.В. Максимов, Ю.М. Шерняков, Е.С. Семенова, А.П. Васильев, А.Е. Жуков, В.М. Устинов, Г.Г. Зегря 4 507
- Электрофизические и оптические свойства InP, облученного большими интегральными потоками нейтронов. В.Н. Брудный, Н.Г. Колин, Д.И. Меркурисов, В.А. Новиков 5 528
- Особенности формирования эпитаксиальных пленок на пористых подложках A^{III}B^V. А.А. Ситникова, А.В. Бобыль, С.Г. Конников, В.П. Улин 5 552
- Пороговый характер формирования наноразмерных островков в системе Ge/Si (100) в присутствии сурьмы. Г.Э. Цырлин, В.Г. Дубровский, А.А. Тонких, Н.В. Сибирев, В.М. Устинов, Р. Werner 5 577
- Особенности сегрегационного перераспределения фосфора при термическом окислении сильно легированных слоев кремния. О.В. Александров, Н.Н. Афонин 6 647
- Поведение структурных дефектов и проводимости в легированных бором пленках *nc*-SiC:H, выращенных методом photo-CVD. О.И. Шевалеевский, S.Y. Myong, K.S. Lim, S. Miyajima, M. Konagai 6 741
- Физические свойства CdTe при совместном легировании V и Ge. С.Ю. Паранчич, Л.Д. Паранчич, В.Н. Макогоненко, Ю.В. Танасюк, М.Д. Андрийчук, В.Р. Романюк 6 744
- 4H-SiC *p-i-n*-диод, полученный совмещением сублимационной и газофазной эпитаксии. Е.В. Богданова, А.А. Волкова, А.Е. Черенков, А.А. Лебедев, Р.Д. Каканаков, Л.П. Колаклиева, Г.А. Саров, Т.М. Чолакова, А.В. Кириллов, Л.П. Романов 6 762
- Особенности физических свойств модифицированной поверхности теллурида кадмия. В.П. Махний 7 826
- Переход от термодинамического режима формирования квантовых точек в системе InAs/GaAs(100) к кинетическому. Ю.Г. Мусихин, Г.Э. Цырлин, В.Г. Дубровский, Ю.Б. Самсоненко, А.А. Тонких, Н.А. Берт, В.М. Устинов 7 853
- Оптические и электрические свойства тонких пластин, изготовленных из нанокристаллических порошков кремния. Н.Н. Кононов, Г.П. Кузьмин, А.Н. Орлов, А.А. Сурков, О.В. Тихоневич 7 868
- IV Международная конференция по аморфным и микрокристаллическим полупроводникам (5–7 июля 2004). 8 914
- Быстрые экзотермические процессы в пористом кремнии. С.К. Лазарук, А.В. Долбик, П.В. Жагино, В.А. Лабунов, В.Е. Борисенко 8 917
- Наноструктурирование кристаллических зерен природного алмаза ионизирующим излучением. Н.А. Поклонский, Т.М. Лапчук, Н.И. Горбачук, В.А. Николаенко, И.В. Бачучин 8 931
- Формирование наноструктур в системе Ga₂Se₃/GaAs. Н.Н. Безрядин, Г.И. Котов, И.Н. Арсентьев, А.А. Стародубцев 9 1025
- Микрофотолуминесценция нелегированного монокристаллического теллурида цинка, полученного неравновесными парофазными методами. В.В. Ушаков, Ю.В. Клевков 9 1029
- Образование наноразмерных структур на поверхности кристаллов *p*-CdTe при однократном воздействии импульсом излучения рубинового лазера. А. Байдуллаева, А.И. Власенко, Л.Ф. Кузан, О.С. Литвин, П.Е. Мозоль 9 1064

- Исследование некоторых свойств структур $\text{Si}-\text{Si}_{1-x}\text{Ge}_x$ ($0 \leq x \leq 1$), выращенных из ограниченного оловянного раствора–расплава методом жидкофазной эпитаксии. Б. Сапаев, А.С. Саидов . . . 10 1183
- Стабилизация заряда на границе со скрытым диэлектриком структур кремний-на-изоляторе. И.В. Антонова . . . 10 1195
- Влияние квантово-размерного эффекта на оптические свойства нанокристаллов Ge в пленках GeO_2 . Е.Б. Горохов, В.А. Володин, Д.В. Марин, Д.А. Орехов, А.Г. Черков, А.К. Гутаковский, В.А. Швец, А.Г. Борисов, М.Д. Ефремов . . . 10 1210
- Электронная структура и спектральные характеристики клатратов Si_{46} и $\text{Na}_8\text{Si}_{46}$. С.И. Курганский, Н.А. Борщ, Н.С. Переславцева . . . 10 1218
- Кинетика фазово-структурных преобразований в тонких пленках SiO_x в процессе быстрого термического отжига. В.А. Данько, И.З. Индутный, В.С. Лысенко, И.Ю. Майданчук, В.И. Минько, А.Н. Назаров, А.С. Ткаченко, П.Е. Шепелявый . . . 10 1239
- Десорбция водорода с поверхности в условиях эпитаксиального наращивания слоев кремния из моносилана в вакууме. Л.К. Орлов, Т.Н. Смыслова 11 1320
- Адсорбция, десорбция, контактная и термическая трансформация молекул C_{60} на поверхности Ta (100). Н.Р. Галль, Е.В. Рутьков, А.Я. Тонтегоде . 11 1325
- Some Aspects to the RHEED Behaviour of LT-GaAs Growth. Ákos Nemesics . . . 11 1398
- Светоизлучающие структуры Si:Er, полученные методом молекулярно-лучевой эпитаксии: фотолюминесцентная спектроскопия высокого разрешения. Д.И. Крыжков, Н.А. Соболев, Б.А. Андреев, Д.В. Денисов, З.Ф. Красильник, Е.И. Шек . . . 12 1448
- Электрические свойства гетеропереходов $n\text{-GaN}/p\text{-SiC}$. О.Ю. Ледаев, А.М. Стрельчук, А.Н. Кузнецов, Н.В. Середова, А.С. Зубрилов, А.А. Волкова, А.Е. Николаев, А.А. Лебедев . . . 12 1452
- Непрерывный режим генерации одномодовых метаморфных лазеров на квантовых точках спектрального диапазона 1.5 мкм. Л.Я. Карачинский, Т. Kettler, Н.Ю. Гордеев, И.И. Новиков, М.В. Максимов, Ю.М. Шерняков, Н.В. Крыжановская, А.Е. Жуков, Е.С. Семенова, А.П. Васильев, В.М. Устинов, Н.Н. Леденцов, А.Р. Ковш, В.А. Шукин, С.С. Михрин, А. Lochmann, O. Schulz, L. Reissmann, D. Bimberg . . . 12 1464
- 6.2. Полупроводниковые приборы (PACS 84; 85)**
- Осцилляции тока при латеральном транспорте в гетероструктурах GaAs/InGaAs с квантовыми ямами. А.В. Антонов, В.И. Гавриленко, Е.В. Демидов, Б.Н. Звонков, Е.А. Ускова . . . 1 53
- Оптические явления в гетероструктурах InAs/GaAs с легированными квантовыми точками и искусственными молекулами. Л.Е. Воробьев, В.Ю. Паневин, Н.К. Федосов, Д.А. Фирсов, В.А. Шалыгин, А.Д. Andreev, Ю.Б. Самсоненко, А.А. Тонких, Г.Э. Цырлин, Н.В. Крыжановская, В.М. Устинов, S. Hanna, A. Seilmeier, N.D. Zakharov, P. Werner . . . 1 59
- Терагерцовая люминесценция гетероструктур на основе GaAs с квантовыми ямами при оптическом возбуждении доноров. Н.А. Бекин, Р.Х. Жукавин, К.А. Ковалевский, С.Г. Павлов, Б.Н. Звонков, Е.А. Ускова, В.Н. Шасти . . . 1 76
- Исследование фотоэлектрических свойств квантовых точек Ge в матрице ZnSe на GaAs. И.Г. Неизвестный, С.П. Супрун, В.Н. Шумский . . . 1 100
- Эффективность лавинных светодиодов на основе пористого кремния. С.К. Лазарук, А.А. Лешок, В.А. Лабунов, В.Е. Борисенко . . . 1 149
- Resonant terahertz response of a slot diode with a two-dimensional electron channel. V.V. Popov, G.M. Tsybalov, M.S. Shur, W. Knar . . . 1 157
- Блоховские колебания в сверхрешетках. Проблема терагерцового генератора. Ю.А. Романов, Ю.Ю. Романова . . . 1 162
- Качественное различие механизмов процесса электроформовки в структурах $\text{Si}-\text{SiO}_2\text{-W}$ для Si n - и p -типов проводимости. В.М. Мордвинцев, С.Е. Кудрявцев, В.Л. Левин . . . 2 222
- Фотоэлектрические свойства структур $n\text{-ZnO:Al/PbPc}/p\text{-Si}$. Г.А. Ильчук, С.Е. Никитин, Ю.А. Николаев, В.Ю. Рудь, Ю.В. Рудь, Е.И. Теруков . . . 2 234
- О механизме инжекционных токов в светоизлучающих $p-i-n$ -структурах на основе гидрогенизированных аморфных сплавов $a\text{-Si}_{1-x}\text{C}_x$: Н.А.А. Андреев . . 2 276
- Варизонный фотоэлектрический детектор ионизирующих излучений. Л. Дапкус, К. Пожела, Ю. Пожела, А. Шиленас, В. Юцене, В. Ясутис . . . 2 281
- Новый физический механизм формирования критического заряда включения тиристорных структур. Т.Т. Мнацаканов, С.Н. Юрков, А.Г. Тандоев . . . 3 372
- Метод измерения времени жизни носителей заряда в базовых областях быстродействующих диодных структур. В.В. Тогатов, П.А. Гнатюк . . . 3 378
- Спектрометрия короткопробежных ионов детекторами на основе CVD-пленок $4H\text{-SiC}$. Н.Б. Строкан, А.М. Иванов, Е.В. Калинина, Г.Ф. Холуянов, Г.А. Онушкин, Д.В. Давыдов, Г.Н. Виолина . . . 3 382
- Фотообразование в структурах $n\text{-ZnO:Al/PdPc}/p\text{-CuIn}_3\text{Ses}$. И.В. Боднар, Е.С. Дмитриева, С.Е. Никитин, В.Ю. Рудь, Ю.В. Рудь, Е.И. Теруков . 4 426
- Исследование статистики носителей в светодиодных структурах InGaN/GaN. Д.С. Сизов, В.С. Сизов, Е.Е. Заварин, В.В. Лундин, А.В. Фомин, А.Ф. Цацульников, Н.Н. Леденцов . . . 4 492
- Возникновение электроусталости в МОП структурах в результате снижения высоты потенциального барьера при полевой ионизации атомов диэлектрика. И.С. Савинов . . . 5 623
- Туннельно-рекомбинационные токи и эффективность электролюминесценции InGaN/GaN светодиодов. Н.И. Бочкарева, Е.А. Zhirnov, А.А. Ефремов, Ю.Т. Ребане, Р.И. Горбунов, Ю.Г. Шретер . . . 5 627
- Влияние эффекта насыщения усиления на мощность излучения полупроводниковых лазеров на квантовых ямах. Г.Г. Зегря, И.Ю. Соловьев . . . 5 636
- Новый элемент памяти на кремниевых нанокластерах в диэлектрике с высокой диэлектрической проницаемостью ZrO_2 для электрически перепрограммируемого постоянного запоминающего устройства. В.А. Гриценко, К.А. Насыров, Д.В. Гриценко, Ю.Н. Новиков, А.Л. Асеев, Д.Х. Ли, Д.-В. Ли, Ч.В. Ким . . . 6 748

- Особенности переноса заряда в диодах Шоттки на основе полужолирующего CdTe.** Л.А. Косяченко, Е.Л. Масляничук, В.М. Склярчук 6 754
- 4H-SiC $p-i-n$ -диод, полученный совмещением сублимационной и газофазной эпитаксии.** Е.В. Богданова, А.А. Волкова, А.Е. Черенков, А.А. Лебедев, Р.Д. Каканаков, Л.П. Колаклиява, Г.А. Саров, Т.М. Чолакова, А.В. Кириллов, Л.П. Романов 6 762
- Влияние нейтронного облучения на свойства нитевидных микрокристаллов n -InSb.** И.А. Большакова, В.М. Бойко, В.Н. Брудный, И.В. Каменская, Н.Г. Колин, Е.Ю. Макидо, Т.А. Московец, Д.И. Меркурисов 7 814
- Особенности физических свойств модифицированной поверхности теллурида кадмия.** В.П. Махний 7 826
- Влияние состояний на границах раздела на емкость и эффективность электролюминесценции InGaN/GaN-светодиодов.** Н.И. Бочкарева, Е.А. Жирнов, А.А. Ефремов, Ю.Т. Ребане, Р.И. Горбунов, А.В. Клочков, Д.А. Лавринович, Ю.Г. Шретер 7 829
- Высокомощные синие флип-чип светодиоды на основе AlGaInN.** Д.А. Закгейм, И.П. Смирнова, И.В. Рожанский, С.А. Гуревич, М.М. Кулагина, Е.М. Аракчсва, Г.А. Онушкин, А.Л. Закгейм, Е.Д. Васильева, Г.В. Иткинсон 7 885
- Сегнетоэлектрический полевой транзистор на основе гетероструктуры $Pb(Zr_xTi_{1-x})O_3/SnO_2$.** И.Е. Титков, И.П. Пронин, Д.В. Машовец, Л.А. Делимова, И.А. Линийчук, И.В. Грехов 7 890
- Мощные биполярные приборы на основе карбида кремния.** П.А. Иванов, М.Е. Левинштейн, Т.Т. Мнацаканов, J.W. Palmour, А.К. Agarwal 8 897
- Миллиметровый/субмиллиметровый смеситель на основе разогрева двумерного электронного газа в гетероструктуре AlGaAs/GaAs с фоновым каналом охлаждения.** Д.В. Морозов, К.В. Смирнов, А.В. Смирнов, В.А. Ляхов, Г.Н. Гольцман 9 1117
- Структуры полупроводник—диэлектрик в фотомешнях видиконов, чувствительных в средней инфракрасной области спектра.** Н.Ф. Ковтонюк, В.П. Мисник, А.В. Соколов 9 1129
- О механизме электролюминесценции в кремниевых диодах с большой концентрацией дислокаций.** А.В. Саченко, Ю.В. Крюченко 9 1132
- Комбинированная модель резонансно-туннельного диода.** И.И. Абрамов, И.А. Гончаренко, Н.В. Коломейцева 9 1138
- Стабилизация заряда на границе со скрытым диэлектриком структур кремний-на-изоляторе.** И.В. Антонова 10 1195
- Терагерцовая электролюминесценция за счет пространственно неярмых межподзонных переходов в квантово-каскадной структуре GaAs/AlGaAs.** Г.Ф. Глинский, А.В. Андрианов, О.М. Сресели, Н.Н. Зиновьев 10 1224
- Квазигидродинамическая модификация приближения плавного канала в теории МОП транзистора.** В.А. Гергель, М.Н. Якупов 10 1246
- Матричные фотоприемные устройства среднего и дальнего инфракрасных диапазонов спектра на основе фотодиодов из $Cd_xHg_{1-x}Te$.** В.И. Стафеев, К.О. Болтарь, И.Д. Бурлаков, В.М. Акимов, Е.А. Климанов, Л.Д. Сагинов, В.Н. Соляков, Н.Г. Мансветов, В.П. Пономаренко, А.А. Тимофеев, А.М. Филачев 10 1257
- Структурные механизмы оптимизации фотоэлектрических свойств пленочных гетеросистем CdS/CdTe.** Г.С. Хрипунов 10 1266
- Электролюминесцентные свойства светодиодов на основе p -Si, подвергнутых деформации.** Н.А. Соболев, А.М. Емельянов, Е.И. Шек, О.В. Феклисова, Е.Б. Якимов 10 1271
- Светодиоды на основе твердых растворов GaSb для средней инфракрасной области спектра 1.6–4.4 мкм.** Т.Н. Данилова, Б.Е. Журтанов, А.Н. Именков, Ю.П. Яковлев 11 1281
- Удаление фторполимерных загрязнений с поверхности кремниевых структур при обработке в потоке атомарного водорода.** Е.В. Анищенко, В.А. Кагадей, Е.В. Нефёдиев, Д.И. Проскурковский, С.В. Романенко 11 1388
- Новый тип высокоэффективных двусторонних кремниевых солнечных элементов с внешними шинами и проволоочной контактной сеткой.** Г.Г. Унгилла, Т.Н. Кост, А.Б. Чеботарева, М.Б. Закс, А.М. Ситников, О.И. Солодуха 11 1392
- Светоизлучающие структуры Si:Er, полученные методом молекулярно-лучевой эпитаксии: фотолюминесцентная спектроскопия высокого разрешения.** Д.И. Крыжков, Н.А. Соболев, Б.А. Андреев, Д.В. Денисов, З.Ф. Красильник, Е.И. Шек 12 1448
- Фоточувствительность гетерофотоэлементов ZnO/CdS/Cu(In,Ga)Se₂ при γ -облучении.** В.В. Емцев, Ю.А. Николаев, Д.С. Полоскин, В.Ю. Рудь, Ю.В. Рудь, Е.И. Теруков, М.В. Якушев 12 1455
- Предельное разрешение по энергии карбид-кремниевых детекторов при спектрометрии ионов.** Н.Б. Строкан, А.М. Иванов, А.А. Лебедев, М. Syväjärvi, R. Yakimova 12 1469
- Идеальный статический пробой в высоковольтных (1 кВ) диодных $p-n$ -структурах с охранными кольцами на основе 4H-SiC.** П.А. Иванов, И.В. Грехов, Н.Д. Ильинская, Т.П. Самсонова 12 1475